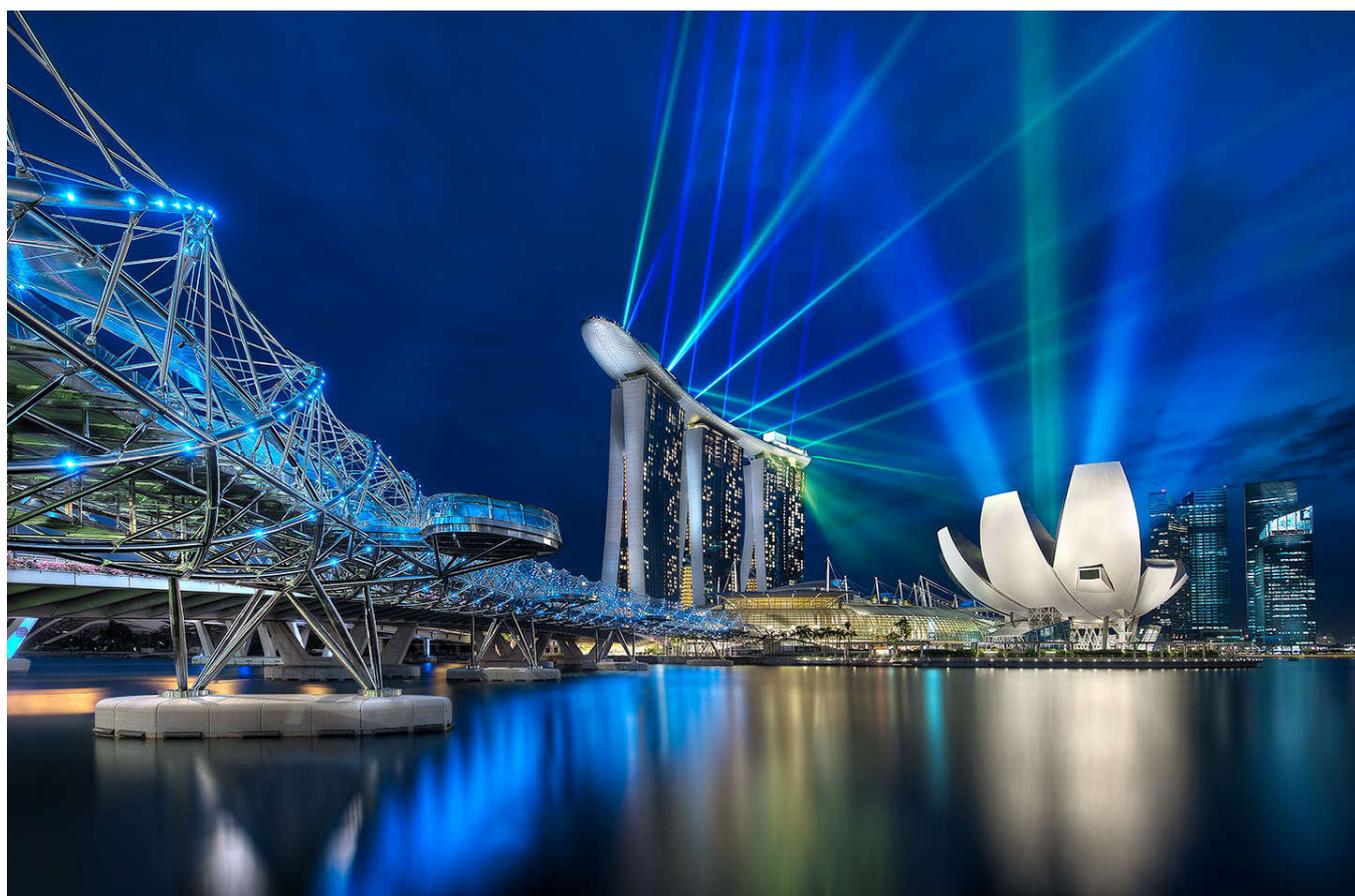


**МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА**

**ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
МОКРІЦЬКИЙ**

Біобібліографічний покажчик



Одеса 2019

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
НАУКОВО-ТЕХНІЧНА БІБЛІОТЕКА

**ВАДИМ АНАТОЛІЙОВИЧ
МОКРІЦЬКИЙ**

Біобібліографічний покажчик

Одеса 2019

УДК 016:621.37

М 74

Укладач : Гнатюк Тамара Юріївна, головний бібліограф
Науково-технічної бібліотеки ОНПУ

Відповідальна за випуск : Банокіна Світлана Григоріївна,
директор Науково-технічної бібліотеки ОНПУ

Вадим Анатолійович Мокріцький : біобібліогр. покажч. / уклад. :
Т. Ю. Гнатюк ; відп. за вип. С. Г. Банокіна ; Одес. нац. політехн. ун-т, Наук.-
техн. б-ка. – Одеса, 2019. – 90 с.

До покажчика увійшли матеріали про наукову, педагогічну, адміністративну діяльність та основні друковані праці видатного вченого, доктора технічних наук, професора Одеського національного політехнічного університету В.А. Мокріцького. Покажчик має бути корисним для науковців, аспірантів, студентів технічних вишів, широкого кола читачів, які цікавляться історією науки та історією Одеського національного політехнічного університету.



МОКРІЦЬКИЙ

Вадим Анатолійович

*Доктор технічних наук, професор,
академік Міжнародної академії інформатизації,
відмінник освіти України*

ПЕРЕДМОВА

Показчик присвячений життю та науковій діяльності доктора технічних наук, професора Вадима Анатолійовича Мокріцького.

Показчик складається з розділів: Основні дати життя та діяльності, Короткий біографічний нарис, Про колег, друзів і про себе, Література про життя та діяльність, Хронологічний показчик друкованих праць, Показчик звітів НДР, Авторські свідоцтва та патенти, Дисертації під науковим керівництвом В.А. Мокріцького.

Бібліографічний опис документів здійснено згідно чинних в Україні державних стандартів: ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «Библиографическая запись. Библиографическое описание», ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис скорочення слів і словосполучень українською мовою», ГОСТ 7.12-93 «Библиографическая запись. Сокращения слов на русском языке».

У бібліографічному описі В.А. Мокріцький вказується як автор, співавтори перелічені в частині відомостей про відповідальність. Документи, що помічені астериском (*), не описані безпосередньо за джерелом: не переглянуті *de visu*.

Бібліографічні записи в показчику мають суцільну нумерацію.

Довідково-пошуковий апарат видання містить допоміжні показчики для пошуку, а саме: алфавітний показчик співавторів і алфавітний показчик друкованих праць. В допоміжних показчиках надаються посилання на відповідні номери бібліографічних описів (позиції) хронологічного показчика друкованих праць.

Бібліографічний показчик розрахований на студентів технічних вишів, аспірантів, докторантів, науковців, істориків науки та працівників наукових бібліотек, широкого кола читачів.

Висловлюємо щире подяку професору В.А. Мокріцькому за консультації та надану особисту інформацію.

ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В.А. МОКРІЦЬКОГО

Вадим Анатолійович Мокріцький народився 9 червня 1937 року в м. Житомирі в родині кадрового офіцера радянської армії Анатолія Степановича Мокріцького та працівниці підприємства зв'язку Олени Григорівни Айрапетянц.

- 1944–1955 – Учень середніх шкіл м.м. Москви, Львова, Ужгорода, спец. школи у Люстдорфі (Одеса), Одеси – за місцем військової служби батька.
- 1955 – Закінчив середню школу № 57 м. Одеси із срібною медаллю. Не пройшов по конкурсу медалістів у Московський енергетичний інститут на спеціальність «Автоматика та телемеханіка». Прийнятий учнем слюсаря на Одеський завод прецизійних верстатів ім. С.М. Кірова.
- 1956–1961 – Студент електротехнічного факультету Одеського політехнічного інституту (ОПІ). Навчався на щойно відкритій спеціальності «Автоматика та телемеханіка».
- 1961–1969 – Асистент кафедри промислової електроніки, а потім – напівпровідникових матеріалів. Старший викладач, заступник декана факультету радіоелектроніки (ФРЕ). Заступник декана інженерно-фізичного факультету.
- 1969–1970 – Аспірант кафедри теоретичної фізики ОПУ, керівник проф. Кузнецов Василь Іванович.
- 1971 – Достроково захистив кандидатську дисертацію на тему «Исследование процессов жидкофазной эпитаксии слоев арсенида галлия для целей оптоэлектроники».
- 1972–1979 – Присвоєно вчене звання доцента. Завідувач кафедри напівпровідникових матеріалів до її об'єднання з кафедрою КПРА ОПІ.
- 1975 – Виконуючий обов'язки проректора з наукової роботи.
- 1976–1982 – Доцент кафедри КПРА ОПІ.
- 1982 – Творча відпустка, захист докторської дисертації на тему «Исследование физико-химических процессов жидкофазной эпитаксии и разработка способов управления свойствами слоев на примере элементарных полупроводников и соединений типа A^3B^5 ».
- 1983 – Присудження вченого ступеня доктора технічних наук за спец. 05.16.07 – Металлургия металлов высокой чистоты и прецизионных сплавов.
- 1983–1987 – Доцент кафедри КПРА. Присвоєно вчене звання професора у 1985 р. Декан факультету автоматика та телемеханіки ОПІ.

- 1987–2000 – Завідувач щойно створеної кафедри мікроелектроніки ОПІ.
- 2000–2004 – Професор кафедри ЕЗІКТ ОПІ.
- 2004– до сьогодні – Професор кафедри інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях.

КОРОТКИЙ БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС

Мокріцький Вадим Анатолійович народився 9 червня 1937 року в місті Житомирі в сім'ї військово-службовця. Вищу освіту здобув в Одеському політехнічному інституті (сьогодні – Одеський національний політехнічний університет, ОНПУ) за спеціальністю «Автоматика та телемеханіка», який закінчив у 1961 році.



У 1960-1961 рр. на електротехнічному факультеті ОПІ здійснюється набір студентів за новими електронними і радіотехнічними спеціальностями, а в 1961 році наказом ректора проф. Ямпольського Стефана Михайловича був сформований факультет радіоелектроніки (ФРЕ), на якому велася підготовка студентів з таких напрямків, як радіотехніка, електроніка, мікроелектроніка та акустика. Деканом цього факультету призначили професора, доктора технічних наук Рвачова Олексія Логвиновича, який був крупним фахівцем з фізики напівпровідників. У 1961 році на новому факультеті створюється кафедра напівпровідникових матеріалів, на яку після навчання був направлений на роботу асистентом Вадим Анатолійович Мокріцький.

З цього часу його життя і робота на протязі 60-ти років пов'язані з ОНПУ. Вадим Анатолійович пройшов довгий, наповнений трудовими досягненнями та науковими звершеннями шлях від лаборанта, асистента, старшого викладача, доцента, до – професора, доктора технічних наук, академіка Академії зв'язку України, академіка Міжнародної академії інформатизації.

В різні роки Вадим Анатолійович Мокріцький працював заступником декана факультету радіоелектроніки та інженерно-фізичного факультету (1963-1967), деканом факультету автоматики та обчислювальної техніки (1984-1987), виконував обов'язки проректора з наукової роботи (1975), виконував адміністративну роботу на посадах завідуючого кафедри напівпровідникових матеріалів і створеною ним в 1986 році кафедри мікроелектроніки (з 1972 до 2000 року).

Кафедра мікроелектроніки за 40 років свого існування пройшла кілька етапів: 1 етап (1961–1979 рр.) – кафедра напівпровідникових матеріалів; 2 етап (1986–1996 рр.) – кафедра мікроелектроніки; 3 етап (1996-2001 рр.) – кафедра засобів телекомунікацій.

Новостворену кафедру напівпровідникових матеріалів очолював в 1961–1969 рр. д-р фіз.-мат. наук, проф. О.Л. Рвачов. Під його керівництвом були організовані перші навчальні лабораторії, спеціальні дисципліни, почала працювати аспірантура. Першими викладачами кафедри стали асистенти В.А. Мокріцький, Л.О. Мозгова, Є.П. Бердніков, Л.О. Лазаренко, Ю.Г. Сухарев. Через відсутність підручників вони навчалися на нових в ті часи

підприємствах (Запорізький титано-магнієвий комбінат, Світловодський завод чистих металів, Запорізький завод напівпровідникових приладів) та наукових установах (Ленінградський фізико-технічний інститут ім. А.Ф. Іоффе, Інститут напівпровідників), на книгах видатних зарубіжних вчених. Лекції студентам читали видатні вітчизняні вчені В.М. Туркевич, С.В. Свечніков, С.І. Радауцан.

Завдяки тісному зв'язку виробництва, науки з навчальним процесом кафедра за короткий термін підготувала і викладачів, і студентів. Випускники кафедри були направлені для роботи на головні підприємства майже всіх республік колишнього СРСР – від Красноярська до Черчика (Узбекистан) та наукові організації Москви, Ленінграда, Києва, де за короткий час вони стали спеціалістами і очолили їх підрозділи.

Викладацький склад кафедри продовжував поповнюватися такими випускниками ОПІ, як А.І. Казаков, В.А. Завадський, науковими співробітниками та аспірантами Ш.Д. Курмашевим, В.А. Дроздовим. Були запрошені також професора інших вузів А.І. Костильов, В.І. Кузнєцов.

Високий рівень і темпи розвитку кафедри дозволили на її основі створити кафедри теоретичної фізики та акустики і ультразвукової техніки. З цих кафедр у 1967 році був організований єдиний на Україні інженерно-фізичний факультет, деканами якого були професор, доктор фізико-математичних наук А.Л. Рвачев, а потім професор, доктор технічних наук В.І. Кузнєцов.

У 1969–1972 рр. кафедру очолював д-р фіз.-мат. наук, проф. М.Т. Мітенко, а в 1972–1979 рр. – кандидат технічних наук, доцент В.А. Мокріцький (кандидатську дисертацію «Дослідження процесу епітаксії шарів арсеніду галію з розчину-розплаву, технологія їх отримання і можливості використання у напівпровідникових приладах» він захистив у 1970 році). У новому приміщенні кафедри на пр. Шевченко було створено наукові та навчальні лабораторії, оснащені сучасним обладнанням, підготовлено конспекти лекцій та методичне забезпечення нових дисциплін. За ці роки на кафедрі була створена наукова школа, яка вирішувала науково-технічні «Проблеми управління властивостями нових напівпровідникових матеріалів мікро- та оптоелектроніки» (науковий керівник проф. В.А. Мокріцький).

Близько 1000 спеціалістів для нової у той час галузі напівпровідникових матеріалів, десятки кандидатів і 3 доктори наук – такий підсумок науково-педагогічної діяльності кафедри напівпровідникових матеріалів за 18 років свого існування.

Незважаючи на ці та інші вагомі досягнення, кафедра напівпровідникових матеріалів в 1979 році була об'єднана з кафедрою конструювання і виробництва радіоапаратури РТФ. У цій новій якості науковий і викладацький склад кафедри зберігав певну автономію, готував кадри вищої кваліфікації, виконував великий обсяг господарсько-договірних і фундаментальних НДР з проблеми «Методологія та засоби управління процесами отримання і властивостями нових напівпровідників для опто- та мікроелектроніки». В країні в ці роки швидкими темпами розвивалася мікроелектроніка.

У 1986 році вона була відроджена як кафедра мікроелектроніки практично у тому ж складі викладачів і науковців. Кафедру очолив доктор технічних наук, професор В.А. Мокріцький (докторську дисертацію «Дослідження фізико-хімічних процесів рідкофазної епітаксії та розробка способів управління властивостями шарів на прикладі елементарних напівпровідників і поєднань типу АЗВ5» він захистив у 1982 році).



У наступні роки кафедра мікроелектроніки продовжила традиції минулих років, працюючи з ще більшою ефективністю. Висока якість її випускників постійно наголошувалося галузевими міністерствами і підприємствами. За всі роки існування кафедри підготовлено понад 20 кандидатів і докторів наук, понад 200 наукових робіт (серед них 15 монографій).

У 2000 році кафедра мікроелектроніки була знову об'єднана з кафедрою ЕСІКТ. За свою 30-річну історію кафедра мікроелектроніки мала вагомі досягнення: стала основою організації інженерно-фізичного факультету, підготувала близько 1200 фахівців, більше 30 кандидатів і 2 докторів наук, видала 5 підручників і навчальних посібників, 12 монографій, понад 700 наукових статей. Вона пишається такими своїми учнями, як заступник Міністра промислової політики України к.т.н. В.В. Зубарев, д.т.н., проф. С.В. Ленков, д.т.н., професор, академік Нью-Йоркської академії наук А.І. Казаков, к.т.н. генеральний директор НВО «Родон» Д.І. Бідник, генеральний директор НВО «Мезон» В.М. Балдук, професор В.А. Завадський, В.В. Лісовенко, А.А. Литвин, Ю.Н. Гаврилук, начальник управління міжнародного співробітництва ОНПУ к.т.н., доц. В.С. Шобік.



З 2001 року Мокріцький В.А. – професор кафедри електронних засобів та інформаційно-комп'ютерних технологій, а з 2004 року – професор кафедри інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях. Галузь наукових інтересів Вадима Анатолійовича –

теоретичні засади радіаційних технологій та створення потужних лазерів з електронним накачуванням енергії. В.А. Мокріцький – засновник наукової школи, результати діяльності якої мають вагому практичну спрямованість. Виконувались роботи за Урядовими та галузевими програмами, на замовлення таких підприємств, як ЗАТ «Завод чистих металів» (м. Світловодськ), заводів напівпровідникових приладів (ПО «Дніпро»,

м. Херсон; ПО «Родон», м. Івано-Франківськ). Сьогодні проводяться дослідження на замовлення Міністерства освіти і науки України. Ці та інші роботи виконуються у взаємодії з такими вищими навчальними закладами та науково-дослідними інститутами України, як Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Одеський національний університет імені І.І. Мечнікова, Одеська військова академія, Інститут фізики напівпровідників Національної академії наук України та іншими.

Основні досягнення цієї школи пов'язані із іменами випускників ОПІ В.А. Бойко, С.М. Дранчука, В.А. Завадського, А.І. Казакова, Ю.Г. Сухарева, В.І. Цапко, В.С. Шобіка, які за короткий час закінчили аспірантуру і стали кандидатами наук, доцентами. Наукові розробки цієї школи були впроваджені у нових методах епітаксії напівпровідників, радіаційної обробки матеріалів, нових електродіодних індикаторів, методах модулювання процесу синтезу складних систем тощо.

З 2004 року робота наукової школи, аспірантури активно продовжувалась в складі кафедри інформаційних технологій проектування в електроніці та телекомунікаціях (зав. кафедри – д-р техн. наук, проф. А.І. Казаков).

Останні роки наукова школа під керівництвом професора В.А. Мокріцького вирішує завдання, пов'язані з проблемами «Керування процесами виготовлення та властивостями напівпровідників для оптоелектроніки», «Напівпровідникові датчики нового покоління для систем контролю радіаційної безпеки». Серед основних досягнень слід відзначити розроблені вперше методи радіаційного керування процесами рідиннофазової епітаксії, електрофізичними властивостями шарів напівпровідникових сполук типу АЗВ5, розвинення теорії масопереносу при рідиннофазовій епітаксії. Розроблено радіаційний датчик нового покоління на основі твердого розчину $Cs_{1-x}P_{1-x}Te$. Розвинуто теоретичні засади створення потужних лазерів з електронним накачуванням енергії. Над вирішенням названих проблем працюють разом з ним такі відомі вчені, як кандидати технічних наук, доценти С.М. Дранчук, С.М. Куріцин, В.С. Шобік; доктор технічних наук, доцент О.В. Маслов; доктор технічних наук О.С. Гаркавенко; доктор технічних наук, професор А.І. Казаков.

Професор В.А. Мокріцький приділяє значну увагу підготовці кадрів вищої кваліфікації. Під його керівництвом працюють аспірантура та докторантура, захищено більш 20 кандидатських і виконано 3 докторських дисертації. Він є автором більше 220 наукових праць, серед яких 15 монографій, наприклад: «Фазовые равновесия в многокомпонентных системах» (1986р.); «Воздействие ионизирующих излучений на материалы электронной техники» (1994 р.); «Физико-технические основы радиационной технологии полупроводников» (2002 р.); «Вплив дефектів функціональних матеріалів на надійність електроніки» (2003 р.); «Епітаксія матеріалів оптоелектроніки» (2004 р.); «Оптоелектроніка інфрачервоного діапазону: матеріали, прилади, системи» (2005 р.); «Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням. Том 1. Механізм генерації, властивості випромінювання» (2006 р.); «Теория и

практика жидкофазной эпитаксии и радиационной технологии полупроводников» (2013 р.).

Крім науково-дослідницької та викладацької діяльності, Вадим Анатолійович бере активну участь у громадській роботі: у різні роки він був членом спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій в Одеському національному політехнічному університеті, Одеському національному університеті ім. І.І. Мечникова, Одеській академії зв'язку ім. А.С. Попова та інших. Сьогодні – член спеціальної ради К 41.052.11 в ОНПУ.

Вадим Анатолійович Мокріцький нагороджений знаком «Відмінник освіти України».

О КОЛЛЕГАХ, ДРУЗЬЯХ И О СЕБЕ (воспоминания)

Официально моя «трудовая деятельность» (шаблоны, шаблоны – куда без них?) начиналась с поступления в Одесский политехнический. Но, сколько помню себя – трудился все время. Во-первых – в школе: контрольные, сочинения, олимпиады, самодеятельность и пр., и пр. Отсюда и первый в жизни успех – серебряная медаль. Но пользы от нее не получилось: при поступлении в Московский энергетический институт в 1955 г. из-за огромного наплыва абитуриентов-медалистов был объявлен среди них (впервые в стране!) конкурсный экзамен по математике, на котором «провалился» – получил четверку (как сказал один экзаменатор другому: «Одессит с таким носом и МЭИ несовместимы»). Но «подаренный» мне свободный год был прожит с пользой: следуя семейной традиции, начатой моим дедом Степаном Ивановичем – церковным певчим – (или своим амбициям), поступил на вокальное отделение Одесского музыкального училища в класс Марии Семеновны Бабаджан. А Одесский политехнический был мною осчастливлен в 1956 г., куда я поступил без экзаменов после собеседования с легендарным ректором В.А. Добровольским при активном участии А.М. Корицина, который на всех этапах моей дальнейшей жизни играл весьма важную роль.

После поступления в ОПИ я и мои товарищи по студенческой жизни сразу осознали как и из кого труд сделал человека. Наша специальность «Автоматика и телемеханика» только утверждалась в стране и впервые была организована в ОПИ. Поэтому нам, на всякий случай, преподавали вместе с профильными дисциплинами и слесарное дело, и основы металлургии, и сварочное дело и т. д. И преподавали это и в теории и в лабораториях так, что по сей день мы владеем минимумом этих навыков. А цена этому для нас – одна неделя каникул зимой и две – летом. Но главное – нас научили на всю жизнь трудиться!

И трудились все мы дружно, со вкусом к учебе: Галя Горшунова, Паша Гизниченко, Толя Лукин, Лиля Лазаренко, Женя Самков, Игорь Ковальчук, Саша Остапенко и другие – все 25 человек. И результат – 20 из нас получали повышенную стипендию (не 45 руб., как все студенты в стране, а 65 руб.). Наверное, поэтому на фото 2011 г. (сколько это нам лет?) мы бодры и все успешны и в жизни, и в работе. Но причина этого не только в нас, а и в наших преподавателях: Н.П. Похило, Н.Г. Голомолзин, Л.И. Захарей, В.В. Скалевой, В.Б. Пуйло, М.Н. Захаров, В.А. Чесноков, А.М. Корицин – всем им огромная признательность. И главный итог – 5 дипломов с отличием, 4 человека – успешные преподаватели ОПИ, все остальные играли ведущие роли на предприятиях отрасли от Одессы до Петрозаводска.



Встреча выпускников, 1966 г.

В эти годы, кроме учебы, я работал внештатным лаборантом на разных кафедрах электротехнического факультета, а на старших курсах – на кафедре «Автоматика и телемеханика», где под руководством В.В. Скалевого два года участвовал в создании первых в стране электронных весов на транзисторах (в замен весов на электронных лампах, созданных ранее на этой кафедре). Назначение таких весов – взвешивание ценных грузов с особой точностью и в движении. Это стало темой моей дипломной работы, которую я защищал на Одесском заводе весов в комиссии, принимавшей этот проект как отчет ОПИ о выполнении хоздоговорной НИР. Итог – в стиле пани Моники: «Никакое хорошее дело не остается безнаказанным». Вместо желаемого мной направления на работу в г. Петрозаводск с квартирой и хорошей зарплатой – ассистент ОПИ без квартиры и 105 руб. зарплаты. Плюс дочка Танечка 1960 года рождения и жена – начальник цеха с 120 руб. зарплаты. И что было делать? Как сказал Б. Окуджава: «...а если что не так – не наше дело, как говорят, – что Родина велела!».

01.07.1961 г. приступил к обязанностям ассистента новой кафедры «Промышленная электроника», а с 01.09.1961 – прочел первую в жизни лекцию на тему «Электронные преобразователи». В конце 1961 г. в ОПИ были организованы факультет радиоэлектроники (ФРЭ) и в его составе – кафедра «Полупроводниковые материалы» (ПМ) для подготовки, одной из первых в стране, инженеров одноименной специальности. Факультет и кафедру возглавил д.ф.-м. наук, профессор Рвачев Алексей Логвинович, прибывший из г. Львова в составе кадрового десанта, состоящего из Стефана Михайловича Ямпольского, назначенного ректором ОПИ, д.г.-м. наук, проф. Кузнецова Василия Ивановича, д.ф.-м. наук, проф. Мищенко М.П., ставшего

заведующим одной из кафедр. Этот период в моей дальнейшей работе и в жизни стал испытанием и качества общего и специального образования, и умения воспринимать новое, принимать непростые решения во всем.

Кафедре ПМ была поручена ускоренная подготовка специалистов для зарождавшихся тогда в стране предприятий полупроводниковых материалов и приборов в городах Запорожье, Херсон, Ивано-Франковск, Киев, Светловодск, Красноярск, Ташкент, Сумгаит и др. Для этого были переведены для обучения на кафедре студенты старших курсов других кафедр ОПИ и выпускники других вузов. Преподавателей этой специальности не было, из учебников – Д. Смит «Полупроводники». В такой ситуации мне уже во 2-ом семестре 1962 г. нужно было читать лекции по дисциплинам физики полупроводников и основам технологии их производства. Выручали меня знания, полученные во время дипломного проектирования, когда нужно было из неполных и разрозненных источников узнавать о материалах и принципах работы транзисторов. Но объем подготовки к лекциям был таким, что спать почти не приходилось. Не легче было и преподавателям, постепенно приходящим работать на кафедру: Л.А. Мозговой, Н.П. Бердникову, Ю.Г. Сухареву, В.И. Бугриенко (к.ф.-м.н) и другим. А к тому времени нужно было создавать лабораторные работы и методические пособия к ним. Но ... все изучили, все сделали своими руками. Незаменимыми в этой работе были наши умельцы – лаборанты Ю.А. Столяренко, И.И. Штепенко и их команда: некоторые «самопальные» стенды лабораторных работ, созданные ими, прослужили многие годы (до появления серийного оборудования).

В известной притче дается совет: чтобы стало легче жить – заведи животных со двора в дом. Примерно так поступил и я – занялся научной работой, понимая сам и слушая заявления проф. Рвачева А.Л. о том, что преподаватель без успехов в науке не состоится. Тему для научной работы выбирал сам: «Характеристики тиристоров в критичных условиях эксплуатации». Работалось успешно, привлек еще к работе ассистента А.В. Титова. Опубликовал нужное количество докладов и статей в центральных изданиях. Показал результаты А.Л. Рвачеву с просьбой стать руководителем диссертации. Получил отказ: не может, так как не является специалистом по приборам. Логично. Погорчался. Пережил. Пошел дальше.

К этому времени А.Л. Рвачев установил связи кафедры со многими ведущими учеными в области физики и техники полупроводников: акад. В.М. Тучкевичем – руководителем Ленинградского физико-технического института (ЛФТИ им. А.Ф. Иоффе), акад. Г.В. Лошкаревым – руководителем ИПАН УССР. Продолжая его усилия, сотрудники кафедры установили связи с другими учеными этих организаций: Алферовым Ж.И., Царенковым Б.В., Гореленком А.В., Шмарцевым Ю.В., Огородниковым В.А., Голубевым В.И. (ЛФТИ), Баранским П.И., Власовой Н.А. (ИПАН) и многими другими. Все они оказывали кафедре неоценимую помощь в организации в их лабораториях практики наших студентов, в консультациях наших исследований. В выборе новых направлений моих исследований мне

постоянно помогали Алексей Гореленок и Борис Васильевич Царенков: подсказали взяться за изучение фотоэффекта в диодах на основе Ti_2O_5 (здесь А.Л. Рвачев был специалистом) и дали образцы титана. Изготовил диоды, провел исследования, успешно опубликовал нужное количество докладов и статей, показал А.Л. Ответ – тематика устарела.

А перед этим в моей жизни произошло важное событие – меня назначили заместителем декана ФРЭ А.Л. Рвачева. Почти по упомянутой выше притче. Встал перед выбором: нужно отказаться от научной работы. Но в это время (1965 г.) произошло два судьбоносных события (шаблоны, шаблоны): во-первых, Алексей Гореленок предложил мне взяться за исследование физики полупроводников для целей оптоэлектроники; во-вторых, на кафедру приехал главный технолог Светловодского завода чистых металлов (ЗЧМ, второй комбинат в Европе) Мстислав Николаевич Пивоваров с рекламными образцами монокристаллов арсенида галлия с целью проведения исследования по их изготовлению и применению. События поистине судьбоносные. Судите сами:

– исследования эпитаксии стали основой всей научной работы моей и моих учеников в течение последующих десятилетий;

– с М.Н. Пивоваровым мы были друзьями до самой его преждевременной кончины.

Но все это стало позже, а тогда я решил начать исследования по новой (третьей по счету!) теме. Оборудовал из каморки в помещении деканата лабораторию, в которой мы ютились с выпускником кафедры (аспирантом В.И. Кузнецова) А.И. Казаковым. Работа преподавателя, зам. декана с трудом сочеталась с научной. Но появились первые успехи, которые отмечали даже участники Всесоюзной конференции по полупроводниковым приборам: «единственный в стране зам. декана, ведущий научную работу».

Пришло время оформлять диссертацию, что уже совсем не сочеталось с другими обязанностями. Помог решить проблему проректор по научной работе В.А. Параил. Он поддержал мое решение поступить в очную аспирантуру под руководством проф. Кузнецова В.И. – известного геолога, специалиста-материаловеда, а кроме того, добрейшей души, широко образованного человека. Это случилось в 1969 г.

Сахалин,
Охотское
море, озеро
Изменчивое.
Жарим
мойву с
В.А.
Параилом



По инициативе М.Н. Пивоварова и моей с Заводом чистых металлов был заключен хоздоговор на выполнение НИР на разработку технологии жидкофазной эпитаксии слоев кремния, арсенида и фосфида галлия. Экспериментальная часть работы проводилась в условиях завода. Лучших условий быть не могло: все технологическое оборудование, вспомогательные службы, лаборатории были в нашем распоряжении. Исполнителями от кафедры стали под моим руководством дипломники Володя и Вера Сигида, Э. Пашенко, В. Орел, Ю. Турчанинов, а активными помощниками – выпускники прошлых лет, технологи завода А. Литвин, В. Макаренко и др. Благодаря этому, за 2 года была выполнена вся программа НИР, создана, внедрена на заводе и отправлена в Одессу уникальная установка, выполнены и блестяще защищены на заводе дипломные проекты, собран и опубликован в печати материал моей кандидатской диссертации. Но работать приходилось по 15–16 часов в сутки. Один пример. Мной был задуман эксперимент по оптимизации режимов охлаждения раствора-расплава. Для этого необходимо было использовать скорость охлаждения менее 1 град/мин, т.е. проводить весь процесс более 15 часов. Поэтому мне приходилось работать почти сутки.



1968 г. Завод чистых металлов. Бригада экспериментального участка:
В.И. Орел (дипломник ОПИ), В.А. Букаев (начальник участка),
Б.Г. Сушко (аппаратчик, будущий депутат ВР Украины).

Аспирантура была завершена досрочно защитой диссертации весной. В 1972 г. зачислен старшим преподавателем, а затем стал доцентом кафедры «Полупроводниковые материалы». По воле ректората, и по неведомым мне причинам, был назначен и.о. заведующего этой кафедры. Радости не испытывал по многим причинам и одна из них – обстановка на кафедре, отношения между сотрудниками. Пришлось учиться делать дело

вопреки всему. По-моему, это удалось, т.к. успешно шел учебный процесс, возобновилась научная работа.

В этот период на кафедре получили развитие два научных направления:

- «Методы управления свойствами полупроводников для целей оптоэлектроники» (руководители В.И. Кузнецов, В.А. Мокрицкий);
- «Электролюминесценция (ЭЛ) и приборы на ее основе» (руководитель Ю.Г. Сухарев).

Это стало основой научной школы, которая действует и сегодня.

Кафедра наполнилась ее выпускниками: Дранчук С.Н., Шобик В.С., Бойко В.А., Цацко В.И., Курицын Е.М. Успешно вели работу выпускники прошлых лет: Казаков А.И., Завадский В.А., Корчков В.И. Всего в НИЧ кафедры работали до 25 человек. Выполнялись хоздоговорные НИР для заводов в городах Херсон, Ивано-Франковск, Киев, Светловодск, Новгород, Жуковский и др. Успешно выполняли научную работу талантливые молодые ученые, которым были поручены отдельные направления общей тематики. Важные результаты получили С.Н. Дранчук, решивший сложные задачи термодинамики жидкофазной эпитаксии (ЖФЭ) с целью оптимизации качества структуры слоев, В.С. Шобик, изучивший физико-химические проблемы гетероэпитаксии в системе $C^4 - A^3B^5$, разработал методику оптимизации условий эпитаксии А.И. Казаков, предложил теорию и технологию наращивания слоев фосфида галлия В.А. Завадский, закончили обучение в заочной аспирантуре с успешной защитой диссертаций в период 1977–1980 гг. сотрудники Завода чистых металлов А.А. Литвин, В.И. Орел, Ю.Н. Турчанинов и др. Результатом их работы стало развитие теории и практики ЖФЭ, известные в стране публикации, внедрение результатов на заводах. Плодотворно развивалось научное направление под руководством доцента Ю.Г. Сухарева. Развита теория ЭЛ, создан ряд приборов, защитили диссертации В.А. Бойко, В.И. Цацко, А.В. Андрианов, Н.Н. Тростянская.

Особо следует отметить то, что в этот период меня заинтересовала проблема влияния ионизирующих излучений на процессы кристаллизации полупроводников. Исследования в этом направлении были поручены Е.М. Курицыну. Выбор исполнителя оказался весьма удачным: им, совместно с сотрудниками института физики АН УССР В.И. Шаховцовым, П.А. Данильченко и другими, была разработана уникальная методика и поставлен эксперимент по ЖФЭ слоев арсенида галлия в поле гамма-излучения. В мировой практике аналогов этому нет. Отдельно следует с благодарностью вспомнить Валерия Ивановича Шаховцова, к сожалению, преждевременно ушедшего из жизни из-за последствий участия в событиях в Чернобыле.

Перечисленные события служат подтверждением успешного формирования научной школы кафедры, правильного выбора направления работы, высокой квалификации сотрудников.



Научный семинар «Жидкофазная эпитаксия слоев полупроводников» при кафедре ПМ ОПИ, 1979 г. Участники – ученые НИИ и заводов Украины, от Москвы и Ленинграда до Томска и Новосибирска.

Первый ряд : Ю.Г. Сухарев (ОПИ), Лева Голубев (ЛФТИ), П.И. Баранский (ИПАН, Украина), М.Г. Мильвидский (Гиредмед, Москва), Ф.Кесеманлы (ИПАН, Баку), Ю.С. Бохолитинов (НИИ ФП, Новосибирск), В.А. Мокрицкий (ОПИ), Н.Г. Рябцев (ИХТ, Москва), В.А. Преснов (ОГУ, Одесса), Ф.С. Шишияну (Кишиневский ПИ).

Одним из важнейших условий успешной работы стало постоянное общение с учеными многих академических и отраслевых НИИ, заводов. Систематически проводились всесоюзные конференции, семинары в Москве, Ленинграде, Киеве, Одессе. Особо следует назвать наших коллег известных ученых, оказавших неоценимую поддержку и помощь в этот период нашей научной школе: М.Г. Мильвидский, В.Г. Рябцев, Ю.В. Шмарцев, В.Н. Романенко, Г.А. Погосов, П.И. Баранский, А.С. Давыдов и многих с ними.

На 6-ой
Международной
конференции
«Росткристаллов»,
сентябрь 1980 г.
Ленинские горы,
Москва: В.С.
Шобик, В.А.
Мокрицкий, Е.М.
Курицын, С.Н.
Дранчук.





Международная конференция по р-п-переходам, 1982 г. Армения, Цахкадзор:
В.Н. Романенко (ЛИСИ), С.И. Гиваргизов (ИФК, Москва), Ю.В. Шмарцев
(ЛФТИ), В.А. Мокрицкий (ОПИ).

В 1979 г. кафедра ПМ завершила выпуск специалистов. Это стало причиной ее объединения с кафедрой КПРА. В этом году ушел из жизни В.И. Кузнецов, много сделавший для воспитания у нас стиля и культуры научной работы, ученого. Он оставил на кафедре, в ОПИ богатое наследие по кристаллографии, минералогии.

В 1981 г. ректорат посчитал необходимым для меня завершить работу над докторской диссертацией. Для этого мне был представлен на полгода творческий отпуск, который я завершил, представив ректору К.И. Заблонскому 1 сентября 1981 г. рукопись диссертации на 550 с., с 3-мя томами приложений (расчеты реальной экономической эффективности, заверенные заводами и управлениями МЭП СССР). Спецсоветов для защиты по моей тематике в тот период не существовало. Поэтому по запросу ОПИ ВАК СССР назначил место защиты в Ленинградском горном институте им. Г.В. Плеханова в совете по специальности «Металлургия чистых металлов и прецизионных сплавов».

И началось... Первое представление работы в Ленинградском политехническом на кафедре металлургии прошло удачно, было много замечаний, советов... Учесть их в работе не успел – закончился срок действия спецсовета. В совете нового состава было назначено повторное представление и затем защита на сентябрь 1982 г. И опять защита не состоялась – эпидемия гриппа в Ленинграде. Новый срок защиты – 12 ноября 1982 г. А 10 ноября умер Л.И. Брежнев... Вот так... Но ВАК проводить защиту разрешил.

Однако на этом проблемы не закончились. С декабря 1982 г. по 30 декабря 1983 г. работа проходила многократные экспертизы по одной причине – поток «обвинительных» анонимок из Одессы. И ни одного отрицательного замечания от научных экспертов! Но анонимки тогда были

важнее. И все же..., Пленум ВАК 31 декабря 1983 г. работу утвердил. С огромной благодарностью вспоминаю неоценимую помощь и поддержку моих ребят: Сережи Дранчука, Славы Шобика, Жени Курицына. Без них вряд ли смог бы все это пережить...

Так закончился этот и начался новый этап жизни и работы. Паузы между ними для меня не было и быть не могло: большая учебная нагрузка, продолжалось выполнение НИР, обучались аспиранты...

В эту устоявшуюся жизнь внес «разнообразие» новый ректор ОПИ – А. Ожогин, присланный из Киева: он решил, что деканами факультетов должны быть доктора наук. Мне было предложено стать деканом ФАВТ, совмещая это с работой на факультете радиоэлектроники. Нелепость этого заставила меня отказаться от такого предложения. Но ректор поставил вопрос по-библейски «вот тебе Ева (ФАВТ), а теперь выбирай себе жену (т.е. уходи)». Получил приглашение на работу от директора НИИ «Шторм» В. Чиркова. Но вездесущий обком партии мою кандидатуру не утвердил. Сдался и стал деканом ФАВТ. Но поставил условие: организация на радиотехническом факультете кафедры «Микроэлектроника». Условие было принято.

Начался один из самых мрачных эпизодов в моей карьере. ФАВТ по праву был одним из наиболее успешных факультетов (тогда его деканом был доцент А.А. Бахтиозин). Но успехи здесь соседствовали с заметными нарушениями планирования, расчета нагрузки, штатов и прочее. Пытаясь устранить их, я восстал против себя некоторых зав. кафедрами, среди которых был, тогда еще проректор, В.П. Малахов. Решил не тратить зря время и силы, и ушел, руководствуясь девизом моих предков: «Честь выше почести». Кроме того, всегда помнил и помню слова великого Булата Окуджавы: «Чувство собственного достоинства удивительный элемент. Нарбатывается годами, а теряется в момент».

В 1985 г. стал профессором по кафедре «Промышленная электроника». Весь 1986–1987 учебный год был посвящен организации кафедры «Микроэлектроника». Практически это свелось к реанимации бывшей кафедры ПМ, объединенной с КПРА: сохранились преподаватели и

К 50-летию ФАВТ
(ИКС) ОНПУ – 2014 г.
Экс-деканы: С.А.
Нестеренко,
В.А. Мокрицкий, Н.П.
Похило, Ф.С Шапо,
Н.Б. Копытчук. Декан
ИКС С.Г. Антошук



дисциплины, учебные и научные лаборатории, помещения и оборудование. Вернулись все прежние преподаватели – доценты С.Н. Дранчук, В.С. Шобик, В.А. Завадский, Е.М. Курицын, В.Н. Рыбин, Ю.Г. Сухарев, В.А. Бойко, Ю.А. Запороженко, ставший профессором после защиты докторской диссертации А.И. Казаков. Продолжила работу научная лаборатория во главе с душой коллектива Н.А. Васьковой, пришли новые научные сотрудники и в их числе – незаменимая А.И. Бондарь. Кафедра стала заметным подразделением в ОПИ, ее составляли почти 90 % сотрудники с ученой степенью (как жаловался тогда проректор Оборский Г.А., по зарплате кафедра была самой дорогой в ОПИ).

Научная школа продолжила сотрудничество с нашими прежними коллегами, но по новым полупроводниковым материалам. Совместно с А.А. Литвиным (ЗЧМ) и Г.А. Погосовым (НИИ в Жуковском) выполнили



Научный семинар «Многокомпонентные полупроводниковые системы» кафедры микроэлектроники – 1987 г. Гости кафедры из Ленинграда (Г.В. и В.Н. Романенко) и Новосибирска

исследование популярного в те годы полупроводникового твердого раствора CdHgTe , сделали фотоприемник на его основе. Продолжили совместно с В.М. Кулаковым и его сотрудниками (НИИ МЭП СССР в г. Ленинграде) работу по радиационной стойкости приборов, издали два справочника по этой тематике (ДСП). В 1987 г. издал долгожданную монографию «Расчет фазовых равновесий ...» совместно с А.И. Казаковым, проф. В.Н. Романенко (зав. кафедрой физики Ленинградского строительного института) и новым

другом нашей кафедры Латинкой Хитовой (университет в г. София, Болгария).

Этот период был наиболее плодотворным для кафедры. И одна из причин этого – обстановка коллективного творчества, взаимопомощи и взаимопонимания, которая существовала в Одесских вузах и предприятиях. Мы участвовали в работе научного семинара при ОГУ им. И.И. Мечникова, руководил которым ректор С.В. Сердюк, проводили научные конференции, публиковали статьи в профильных международных журналах, издаваемых ОПИ и ОГУ, приглашали для совместной работы ученых из Москвы, Ленинграда, Киева и др. научных центров.

Заметно способствовал такой обстановке переезд в Одессу из г. Томска известного ученого, директора НИИ полупроводниковых приборов проф. В.А. Преснова. Виктор Алексеевич, со свойственной ему энергией, организовал при ОГУ научную лабораторию, которая занялась проблемой искусственных алмазов. Основой этого научного коллектива стали выпускники нашей кафедры. Успешно работала в этой лаборатории группа, созданная братьями Юрием и Сергеем Ротнерами. Они открыли новое научное направление – лазерные технологии в производстве мощных приборов на основе керамики. В последствие лаборатория стала самостоятельной фирмой ЛАЭТ. При ней был создан филиал нашей кафедры, на котором успешно проводились лабораторные работы. (Фирма ЛАЭТ продолжает работу под руководством к.ф.-м.н, доц. С.М. Ротнера, несмотря на тяжелые проблемы, характерные сегодня для нашей страны).

Виктор Алексеевич Преснов много лет работал в Одессе, являя нам пример своей энергией, доброжелательностью, постоянным поиском нового. Его ученики работают сегодня в Одессе, Херсоне. Мы тесно сотрудничаем с одним из них, д.ф.-м.н., проф. И.М. Викулиным.

Важное место в научной жизни Одессы в это время занимал НИИ «Элемент», руководимый к.ф.-м.н, доц. В.А. Прохоровым. Здесь также работало много наших выпускников, выполнялись дипломные проекты, совместные научные работы. К сожалению, НИИ разделило общую судьбу украинской науки. Но с Валерием Анатолиевичем у нас и сегодня существует творческое сотрудничество.

В 1987 г. отметили мое 50-летие. Благодаря усилиям сотрудников кафедры, выпускников прошлых лет и друзьям юбилей стал заметным событием. В нем активно участвовали выпускники В. Балдук (директор завода полупроводниковых приборов, г. Кишинев), Я. Потапенко (зав. кафедры физики сельхозинститута, г. Одесса) и его супруга В. Рулева, А. Литвин, Ю. Турчанинов (от завода чистых металлов), друзья из Москвы, Ленинграда и особо – из Одессы. Это стало свидетельством известности и авторитета кафедры в научном мире Одессы и страны.

За повседневными делами не очень были заметны угрозы грядущего кризиса. Но развал СССР и последовавшая за этим «независимость» от всего и всех стали чувствительными, болезненными с первых месяцев. Стали рваться по живому связи с организациями, заводами вне Украины, резко

упали интерес и возможности выполнения совместных работ в Украине, возник хаос с подчиненностью министерствам. И, что самое болезненное, стали теряться связи с коллегами, друзьями. Рухнула прежняя активная жизнь, а новая не возникала.

Постепенно общий спад активности в стране коснулся ОПИ и кафедры. Сокращался прием студентов, уменьшался объем учебной работы, предстояло сокращение штатов. Усугублялось это еще и непрофилирующим статусом кафедры. Поэтому мне было разрешено ректоратом провести практически безнадежную работу – добиться в МОН Украины организации подготовки на кафедре инженеров по специальности «Приборы и системы телекоммуникации». Думаю, что мне просто повезло, и я за несколько недель добился решения сразу о подготовке и бакалавров, и магистров. Однако праздник не состоялся: в ректорате полученную мной лицензию положили в сейф, где она пролежала без применения до конца срока действия. Причины этой ... стали понятны только в 2000 г.

К сожалению, 25 декабря 1995 г. после тяжелой болезни ушел из жизни Ю.Г. Сухарев, один из самых опытных преподавателей. Это был тяжкий удар. Но работа продолжалась. Во избежание сокращения преподавателей сократили зарплату до 0,7 ставки. Но все держались дружно, не роптали. Впрочем, не все: преподнес «подарок» выпускник кафедры, выпускник ее аспирантуры д.т.н., проф. А.И. Казаков. Он соблазнился посулами зав. профилирующей кафедры, декана И.Н. Еримичоя и перешел работать к нему. Не хочу оценивать неприличную выходку декана, но поведение А.И. Казакова не удивило: ранее он уходил с кафедры на работу к В.А. Преснову – вернулся, затем уезжал работать в Аргентину – вернулся. Кафедра относилась к этому с пониманием; как говорится: «Рыба ищет где глубже, а человек, где ... рыба». Но этот уход стал безвозвратным: тогда это могло быть предвидением «течи в корабле»? В этот период я не раз предлагал объединить кафедры «Микроэлектроника» (МЭ) и КПРА, но получал отказ. Вскоре стала ясной его причина.

В 2000 г. заканчивались контракты у 4 преподавателей кафедры МЭ и 6 преподавателей КПРА. Для спасения преподавателей КПРА был сделан ловкий ход: объединить кафедры. Объединенная кафедра (15 человек – от КПРА) в процессе перевыборов дружно проголосовала за сохранение преподавателей КПРА (из них 1 с ученой степенью). Так были уволены доценты С.Н. Дранчук, В.А. Бойко и выпускник докторантуры В.А. Завадский. Правда, проректор по кадрам Г.А. Оборский обещал мне твердо, что в сентябре их зачислят в ОПИ. Но 1 сентября услышал: «Обращайтесь к декану И.Н. Еримичою, это его дело». Не хочу оценивать уровень неприличия этого... Удар был тяжкий: кроме ущерба для судьбы каждого из ребят, которые остались без средств к существованию, рушились планы и надежды на работу научной школы.

(Отступление 1. Удивляет деловая бессмысленность этой акции. Или это было последствие противостояния на ФАВТ? Прошло 14 лет, и спустя столько времени так проявиться? Впрочем, возможно я неправ, и просто

память у В.П. Малахова не только хорошая, но и злая? Получается почти сюжет из анекдота о скорпионе: «... прости, не сдержался: ну, характер такой»).

Уволенным ребятам пришлось очень трудно и материально, и морально: остаться без работы перспективным, талантливым молодым преподавателям по злой воле чиновника. Что может быть обиднее? Но ребята были достаточно быстро приглашены на работу в ОНМА на кафедру «Морская электроника», где ценят кадры. В.А. Завадский вскоре стал ее заведующим, нашли себя там доценты С.Н. Дранчук и В.А.Бойко. Кстати, основу этой кафедры и радиофака ОНМА составляли уже в те годы выпускники факультета радиоэлектроники ОНПУ доценты Н.И. Ковалев, П.В. Пышный, проф. В.М. Кошевой и многие другие. Вот так-то.

Наступил последний, 2000-й, год 20-го века. «Наступил» достаточно болезненно на самолюбие, на возможности вести коллективную научную работу. Но зато появилась возможность публиковать результаты прошлых лет, ранее ограниченная режимными правилами. Получилось почти по Губерману:

***«Любил я книги, выпивку и женщин,
И большего у бога не просил.
Теперь азарт мой возрастом уменьшен.
Теперь на книги не хватает сил».***

Почти ... потому что, как раз на книги «хватало сил». Тем более, что к прежним моим соавторам, С.Н. Дранчуку, Е.М. Курицыну, В.С. Шобику и другим, которые не оставили меня, продолжили совместную работу, присоединился С.В. Ленков. О нем, о его месте в моей работе и жизни следует сказать отдельно. Сергей Васильевич окончил ОПИ в 1977 г. по нашему факультету и быстро проявил многие свои таланты. Он стал директором НИИ электроники в Одессе, по решению ВАК в связи с высоким уровнем результатов научной работы защитил докторскую диссертацию, минуя кандидатскую. По приглашению Киева стал руководителем научного центра Военного института при КНГУ им. Т.Г. Шевченка, а затем редактором сборника научных трудов, председателем спецсовета и членом других советов. В этом ему помог его особый талант – организаторский. В сочетании с моими усилиями в качестве редактора были изданы все монографии, начиная с 2000 и до 2018 гг. – всего около 20 книг по полупроводниковой электронике и другим темам. Надо воздать должное незаменимой помощнице – А.И. Бондарь: без ее квалификации и энтузиазме таких результатов не было бы. В этот же период защищали кандидатские и докторские диссертации, например, А.А. Савельев, О.В. Поляруш, А.А. Пашков, А.С. Гаркавенко, О.В. Банзак и многие, многие другие. Среди тем монографий и диссертаций следует отдельно выделить такие, как теория и практика мощных лазеров, развитие радиационных технологий.



В.А. Завадский, А.И. Бондарь, В.А. Мокрицкий, С.В. Ленков



На конференции по физике полупроводников, 2007 г.: В.В. Ковальчук,
В.А. Мокрицкий, С.В. Ленков, В.А. Дроздов

По результатам этой многолетней работы Сергей Васильевич стал Заслуженным деятелем, лауреатом премии Украины по науке.



50-летие В.А. Бойко, 22.08.2001 г.: В полном составе преподаватели бывшей кафедры «Микроэлектроника» с семьями

В этот период жизнь в ОНПУ шла своим чередом. По принципу «где-то убудет, а где-то прибудет» в 2004 г. была организована профилирующая кафедра «Информационные технологии проектирования в электронике и телекоммуникациях» для подготовки бакалавров и магистров по специальности «Компьютерные науки». Заведовать кафедрой был назначен профессор, д.т.н. А.И. Казаков. Преподавательский коллектив был создан из членов бывшей кафедры «Микроэлектроники». Предложено было и мне стать профессором новой кафедры. Согласился. Не жалел об этом тогда, не жалею и сейчас. Все знакомые, успешные коллеги. Анатолий Иванович принял спокойный стиль руководства без излишнего административного фанатизма.

Преподаватели и сотрудники новой кафедры «Информационные технологии проектирования в электронике и телекоммуникациях», 2004 г.



Работа, жизнь продолжилась в несколько иных заданных условиях. Однако сочетание полной загрузки в учебной работе, руководство НИР и издательской работы требовало затраты многих сил и времени. Последней каплей стали обстановка в стране, майдан, война в Донбассе, Крым ... Результат – инфаркт в августе 2014 г. Но повезло: выжил, благодаря врачу 3-й кардиоклиники О.А. Кардаш и Т.Ю. Столяренко из санатория Лермонтовский.

Отдельная благодарность моим ученикам, сотрудникам кафедры и факультета, дипломникам, которые не оставили меня в беде и сделали осознанной необходимость срочного возврата к прежней активной жизни. Поэтому уже в ноябре она и продолжилась. Спасибо.



В.А. Мокрицкий с бакалаврами: И. Непран (диплом с отличием), Ю. Кравченко, Д. Буртный – 06.07.2016 г.



В.А. Мокрицкий с магистром Е. Головченко, 2019 г.

Продолжилось руководство НИР, издание монографий по радиационным датчикам и жидкофазной эпитаксии – темам докторских диссертаций О.В. Банзак и В.А. Завадского, подготовка трех учебников, чтение лекций по пяти дисциплинам, руководство дипломниками и т.д. и т.п.

Во многом активной жизни помогали мои разнообразные увлечения. Продолжил освоение сельских профессий – виноделие, с помощью незаменимого верного помощника – внука Андрея, огород и прочее. Не забывал и охоту. Правда,

пришлось ограничиться зимним ее вариантом. Во многом это стало возможным благодаря моим друзьям из коллектива военных охотников, что при военной академии, В.Н. и Н.В. Оленевым, И.Зубову и многим другим.



Почти «Итальянский полдень» К. Брюллова: виноград есть, но не хватает некоторых соблазнительных деталей его картины.



«Запрягайте хлопці коней ...» та ... пора пахать.

«Охотнички» на привале. Почти по В.Г. Перову:
«Запивала»
В.А. Мокрицкий
(район с. В.-
Михайловки –
с. Кучурганы)



В этот период укрепилось наше давнее сотрудничество с талантливым ученым д.т.н. О.В. Масловым. Этому послужило дальнейшее развитие исследований применения ионизирующих излучений. Особенность Олега Викторовича – генерирование прекрасных научных идей. Но не только это – он при этом еще и знает, как воплотить свои идеи. Олег Викторович предложил идею создания нового поколения датчиков и спектрометров гамма-излучения. В любой цивилизованной стране это вызвало бы существенный интерес: только возможность применения таких приборов для скрытного обнаружения нелегальных ядерных материалов – находка для служб безопасности. Олег Викторович заинтересовал этим Швецию, но не наших деятелей. С 2015 г. успешно проводятся исследования по этой тематике. Проблема – изготовление приборов и их внедрение.

(Отступление 2. Судьбы таких ученых, как д.т.н. С.В. Ленков, д.т.н. О.В. Маслов – грустный пример того, как власти Украины бездарно разбазаривают ценнейший научный потенциал – талант таких ученых. Причем речь идет даже не о создании им условий работы. Нет. Установите в стране нужную обстановку работы «по правилам», стабильность такой обстановки. А такие, как С.В., О.В. и подобные им сами создадут нужные условия, сами организуют и выполняют работы. Не нужно им будет помогать, только не мешайте).



В.А. Дроздов, О.В. Маслов, С.В. Ленков

Подошел 2018 г. – год 100-летия ОНПУ. Не скрою, много ожидал для себя от этого юбилея. Как-никак 57 лет жизни отдано исключительно ОНПУ. И жизни активной, с неплохими результатами. И ожидание не было пассивным: подготовил к изданию три учебника (второе издание учебника по микроэлектронике, учебники «Квантовая электроника» и «Математика»). Но ... все это осталось не замеченным. Этого следовало ожидать: если живешь по принципу: «Не верь, не бойся, не проси», то знай, что все достанется тем, кто «верит, боится, просит». Ладно, время все поставит на свои места.

Юбилеи приходят и уходят, а будни продолжаются. Как-то незаметно подошел год 2020, знаменательный по сочетанию симметрии, четности да еще и високосный. По слухам, он будет удачным финансовым годом для всех предпринимателей. Пусть так будет для них. И для нас это будет нелишним. Но события в начале года не радуют. Начавшийся процесс сокращений в вузах Одессы дошел и до ОНПУ: объявлено об объединении нашей кафедры ИТПЭТ с родственной по профилю кафедрой информационной безопасности. То ли еще будет Впрочем, это, наверное, проявление известной закономерности: история повторяется сперва в виде ...

Однако приход Нового года означает переход от воспоминаний к подведению итогов: что сделано, какова цена этому, что будем делать и т.д. Но не знаю, как это сделать. Что сделано – описано выше. А какова цена ...? Как оценить? По научным трудам ...? Не знаю. Пусть оценят те, кто ими воспользовался. По учебникам ...? Пожалуй, но пусть это сделают студенты, которые по ним учились. По всем моим ученикам, их делам? Вот! Так, наверное, будет правильно. Все они стали успешными людьми и близкими мне друзьями: мы взаимодействуем, встречаемся со многими из них до сих пор, знаем все друг о друге. И я знаю, что все они живут честно, с пользой для всех.

Сегодня в мире возник острый дефицит порядочных, добрых людей. Это ощущается везде и во всем. Надеюсь, что я и мои друзья, наши немаленькие семьи с их детьми, внуками и правнуками создадим – вместе с такими, как мы – критическую массу добропорядочности, которая, подобно «последней соломинки у верблюда», сломает хребет монстру всеобщего зла, который правит, к сожалению, сегодня в мире. Если не мы, – то наши внуки, правнуки, которые по нашему примеру живут и будут жить, созидать с честью. Это и есть главный итог, ибо ЧЕСТЬ ВЫШЕ ПОЧЕСТИ.



В.А. Мокрицкий

ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ

Гончарук Г. И. Выбор одесских политехников / Г. И. Гончарук. – Одесса : Астропринт, 2006. – 216 с. : ил. – С. 18, 22.

История Одесского политехнического в очерках / авт.-сост. : Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь ; под ред. В. П. Малахова. – Одесса : Астропринт, 2003. – С. 379–380.

История Одесского политехнического в очерках / авт.-сост. : Ю. С. Денисов, В. И. Бондарь ; под ред. В. П. Малахова. – Одесса : Астропринт, 2000. – С. 268–269.

К 40-летию создания радиотехнического факультета в Одесском национальном политехническом университете / авт.-сост. : П. Ю. Баранов, И. Н. Еремичой, В. Н. Николаенко [и др.] ; МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т. – Одесса, 2004. – С. 31, 32 ; 34–37.

Кто есть кто в ОНПУ : посвящ. 90-летию, 1918 – 2008, ОНПУ. – Одесса : Наука и техника, 2008. – С. 71.

Літопис досягнень сучасної України : «Успішні професіонали України» / редкол. : Ю. А. Шеремета (голов. ред.) [та ін.]. – Київ : Альфа-Віта, 2018. – С. 72–73.

Наукова еліта Одещини. – Одеса, 2005. – Ч. 1 : Доктора наук и профессора. – С. 149–150.

Одесский политехнический институт : краткий ист. очерк (1918–1968) / авт.-сост. Е. И. Цымбал, В. В. Никулин. – Киев, 1968. – С. 155.

Труды Одесского политехнического университета : Одеський політехнічний : 90 років творчої діяльності (1918–2008) / МОН України, Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Наука і техніка, 2008. – Спецвыпуск. – С. 125, 129, 140–141.

Хто є хто в ОНПУ : довід. до 100-річчя ОНПУ (1918–2018) / уклад. В. І. Бондар ; під заг. ред. Г. О. Оборського. – Одеса : ОНПУ, 2018. – С. 49.

ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

1966

1.*Особенности импульсного управления и работы при обратном смещении цепи управления тиристоров средней мощности / А. Л. Рвачев, А. В. Титов, В. А. Мокрицкий // Всесоюз. совещание по физ. явлениям р-п-переходах в полупроводниках. – Тбилиси, 1966.

1968

2. *Измерение вида вольтамперной характеристики тиристоров при отрицательном смещении в цепи управления / В. А. Мокрицкий, А. Л. Рвачев, А. В. Титов // Полупроводниковые приборы и их применение. – М., 1968. – № 21.

3. *Исследование начальных стадий кристаллизации автоэпитаксиальных слоев арсенида галлия / В. А. Мокрицкий, В. И. Кузнецов // Механизм и кинетика кристаллизации : материалы конф. – Минск, 1968.

4. *Исследование процесса зарождения пленок арсенида галлия при ориентированном наращивании из раствора / В. А. Мокрицкий, В. И. Кузнецов // Механизм и кинетика кристаллизации : материалы конф. – Минск, 1968.

1969

5. Свойства силовых управляемых вентилях при обратном смещении цепи управления / В. А. Мокрицкий, А. Л. Рвачев, А. В. Титов // Электромашиностроение и электрооборудование : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1969. – Вып. 9. – С. 61–64. – Библиогр.: 4 назв.

6. Свойства тиристоров типа Д-235, 238 в режиме импульсного управления / В. А. Мокрицкий, А. Л. Рвачев, А. В. Титов // Электромашиностроение и электрооборудование : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Харьков, 1969. – Вып. 8. – С. 48–53. – Библиогр.: 2 назв.

1970

7. Структурні властивості епітаксійних шарів арсеніду галія / В. А. Мокрицький // Фізика та хімія : наук.-техн. зб. / МВ і ССО УРСР, Одес. політехн. ін-т. – Одеса, 1970. – С. 26–29. – Бібліогр.: 3 назви.

8. Исследование процесса эпитаксии слоев арсенида галлия из раствора-расплава, технология их получения и возможности использования в полупроводниковых приборах : дис. ... канд. техн. наук / В. А. Мокрицкий ; науч. рук. В. И. Кузнецов ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1970. – 199 с. : рис., фот. – Библиогр.: 236 назв.

9. *Исследование условий эпитаксии арсенида галлия / В. Мокрицкий, В. Кузнецов, В. Букаев, Г. Песоцкий // Кристаллизация и фазовые превращения. – Минск, 1971.

1971

10. *Влияние ультразвуковых колебаний на процесс эпитаксии слоев / В. А. Мокрицкий, В. И. Орел // Механизм и кинетика кристаллизации : докл. IV Всесоюз. совещ. – Минск, 1971.

11. *Исследование свойств перехода в системе подложка-эпитаксиальный слой / В. И. Кузнецов, В. А. Мокрицкий // Вопросы микроэлектроники и физики полупроводниковых приборов : материалы всесоюз. конф. – Тбилиси, 1971.

12. *Исследование условий эпитаксии арсенида галлия / В. А. Мокрицкий, В. И. Кузнецов, В. А. Букаев, Г. Песоцкий // Кристаллизация и фазовые превращения. – Минск, 1971.

13.*К феноменологической теории жидкофазной эпитаксии / А. И. Казаков, В. А. Мокрицкий, В. И. Кузнецов // Вопросы микроэлектроники и физики полупроводниковых приборов : материалы Всесоюз. конф. – Тбилиси, 1971.

14. *Эпитаксия германия из раствора-расплава для получения многослойных систем / А. И. Казаков, В. А. Мокрицкий, В. И. Кузнецов // Вопр. микроэлектроники и физики полупроводниковых приборов : материалы Всесоюз. конф. – Тбилиси, 1971.

15. *Эпитаксия слоев фосфида галлия для светодиодов / В. А. Завадский, В. И. Кузнецов, В. А. Мокрицкий // Вопросы микроэлектроники и физики полупроводниковых приборов : материалы Всесоюз. конф. – Тбилиси, 1971.

1972

16. *Влияние состава молекулярного пучка на свойства тонких пленок / В. А. Мокрицкий, Е. Я. Самков, М. П. Ткач // Основ. задачи микроэлектроники и области ее применения : материалы Всесоюз. науч. конф. – М., 1972.

17. О возникновении структур взаимных границ между кристаллами / В. И. Кузнецов, В. А. Мокрицкий // Минералогия : сборник / Львов. гос. ун-т им. И. Франко. – Львов, 1972. – № 26. – С. 351–355.

18. *Повышение структурного совершенства эпитаксиальных слоев фосфида галлия / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, В. И. Кузнецов // Основ. задачи микроэлектроники и области ее применения : материалы Всесоюз. науч. конф. – М., 1972.

19. Теоретическое исследование процесса эпитаксии / В. А. Мокрицкий, А. И. Казаков // Укр. физ. журн. – 1972. – Т. 17, № 9. – С. 117.

1973

20. Инструкция к лабораторным работам по курсу «Технология радиоаппаратостроения» для специальности 0705 «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры» / сост. : В. А. Мокрицкий, М. П. Ткач ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1973. – Ч. 1 : Исследование процессов нанесения гальван. покрытий деталей РЭА. – 44 с.

21. Инструкция к лабораторным работам по курсу «Технология радиоаппаратостроения» для специальности 0705 «Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры» / сост. : В. А. Мокрицкий, М. П. Ткач ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1973. – Ч. 2 : Исследование процессов образования и свойств монтаж. соединений РЭА. – 32 с.

22 *Определение разориентированности монокристаллических подложек и наращиваемых на них слоев на ранней стадии эпитаксии / В. И. Кузнецов, В. А. Мокрицкий // Физика и химия обработки материалов. – 1973. – № 3.

23. *Селективное наращивание германия из раствора в расплаве / В. А. Мокрицкий, А. И. Казаков, В. Б. Смолкин, В. В. Павлов // Электрон. техника. Полупроводниковые приборы. – М., 1973. – Вып. 5.

24. *Природа несовершенств структуры эпитаксиальных слоев арсенида галлия / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, А. И. Казаков, Э. М. Пащенко // Генерация СВЧ колебаний с использованием эффекта Ганна. – Новосибирск, 1973.

25. Уменьшение плотности дислокаций в эпитаксиальных слоях фосфида галлия / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, В. И. Кузнецов // Изв. АН СССР. Сер. : Неорг. материалы. – 1973. – Т. IX, № 8. – С. 1443–1444. – Библиогр.: 10 назв.

1974

26. Гетеропереходы фосфид галлия-кремний в приемниках ИК-излучения / В. А. Мокрицкий, В. М. Желудков, В. А. Завадский // Физ. процессы в гетеропереходах : докл. Всесоюз. конф. – Кишинев, 1974. – С. 132.

27. *Исследование приемников ИК-излучения на основе гетероэпитаксиальной системы кремний-фосфид галлия / В. А. Мокрицкий, В. М. Желудков, В. А. Завадский // 1 Всесоюз. конф. – М., 1974.

1976

28. Влияние кристаллографической ориентации на рост и свойства слоев $\text{Al}_x\text{Ga}_{1-x}\text{As}$ / В. А. Мокрицкий, В. Ф. Коваленко, И. Е. Марончук, В. И. Орел // Изв. АН СССР. Сер. Неорган. материалы. – 1976. – Т. 12, № 4. – С. 623–626. – Библиогр.: 6 назв.

29. Очистка при кристаллизации из раствора в расплаве / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, А. И. Казаков // Физика и химия обработки материалов. – 1976. – № 3. – С. 147–149. – Библиогр.: 3 назв.

1977

30. Гетероэпитаксия слоев полупроводниковых веществ из многокомпонентных растворов / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, В. С. Шобик // Физика и химия обработки материалов. – 1977. – № 4. – С. 137–143. – Библиогр.: 14 назв.

1978

31. Возможности гетероэпитаксии в системе $\text{Sn-Ge-G}_2\text{As}$ / В. А. Мокрицкий // Электрон. техника. Сер. : Материалы. – М., 1978. – Вып. 8. – С. 70–72.

32. *Гетероэпитаксия слоев соединений из жидкой фазы на подложках элементарных полупроводников / В. А. Мокрицкий, В. С. Шобик // Электрон. техника. Сер. : Материалы. – М., 1978. – Вып. 9.

33. Повышение селективности травителя для исследования тонких слоев кремния / В. А. Мокрицкий, А. А. Литвин, С. Н. Дранчук // Изв. АН СССР. Сер. : Неорган. материалы. – 1978. – Т. 14, № 4. – С. 769–770.

34. Программа, методические указания и контрольные работы курса «Микроэлектроника» для студентов заочного отделения специальности 0612 – Промышленная электроника / Одес. политехн. ин-т ; сост. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1978. – 32 с.

35. Программа и методические указания курса «Физические основы электронной техники» для студентов заочного отделения специальности 0612 – Промышленная электроника / Одес. политехн. ин-т ; сост. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1978. –36 с.
36. *Структурные свойства эпитаксиальных слоев фосфида галлия / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Литвин // Тез. докл. V симп. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск, 1978. – С. 108.
37. Трехмерные дефекты эпитаксиальных слоев фосфида галлия / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Литвин // Электрон. техника. Сер. 6 : Материалы. – М., 1978. – Вып. 10. – С. 51–57.
38. Учебные задания по курсу «Физические основы электронной техники» для студентов заочного отделения специальности 0612 / Одес. политехн. ин-т ; сост. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1978. – 48 с.
39. *Эпитаксия слоев полупроводниковых материалов в поле гамма-облучения / В. А. Мокрицкий, Б. Данильченко, Е. М. Курицын, В. И. Шеховцов // Тез. докл. V симп. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск, 1978.

1979

40. *Влияние облучения на диффузию бора в эпитаксальные слои кремния / Е. М. Курицын, В. А. Мокрицкий, В. И. Шеховцов // Физ. основы радиац. технологии в твердотел. электрон. приборах. – Киев, 1979.
41. Пути повышения структурного совершенства слоев фосфида галлия при эпитаксии из жидкой фазы / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Литвин, В. С. Шобик // Электрон. техника. Сер. : Материалы. – М., 1979. – Вып. 11. – С. 69–77.
42. *Радиационная стойкость материалов / В. С. Шобик, С. Н. Дранчук, В. М. Кулаков, В. А. Мокрицкий // Полупроводниковые материалы : справочник. – Л., 1979. – Дополнение 4.
43. *Радиационная стойкость материалов / В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицын, В. М. Кулаков // Полупроводниковые материалы : справочник. – Л., 1979. – Дополнение 6.
44. Структурные дефекты в многослойных системах высоковольтных транзисторов на эпитаксиальных структурах / В. А. Мокрицкий,

С. Н. Дранчук, С. Д. Легеева, В. В. Симаков // Электрон. техника. Сер. 2 : Полупроводниковые приборы. – М., 1979. – Вып. 2 (128). – С. 73–80.

45. *Эпитаксия слоев в радиационном поле / В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицин, Б. Г. Данильченко, В. И. Шеховцов // 2-е совещ. по использованию радиац. методов в технологии пр-ва полупроводниковых материалов и приборов. – Обнинск, 1979.

1980

46. *Влияние легирования на структурное совершенство эпитаксиальных слоев фосфида галлия / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Литвин, В. С. Шобик // Электрон. техника. Сер. : Материалы. – М., 1980. – № 8.

47. *Влияние пересыщения кристаллизационной среды на структурное совершенство эпитаксиальных слоев / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Литвин, В. С. Шобик // Рост из расплавов и высокотемператур. растворов : тез. докл. VI Междунар. конф. по росту кристаллов, 10–16 сент. 1980 г. – [Б. м.], 1980. – [Т. III]. – С. 394–395.

48. Гетероэпитаксия слоев соединений из жидкой фазы на подложках из элементарных полупроводников / В. А. Мокрицкий, В. С. Шобик // Проблемы роста полупроводниковых кристаллов и пленок : тр. V симп. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок : сборник / АН СССР, Ин-т неорганической химии. – Новосибирск, 1979. – Ч. 1. – С. 152–163. – Деп. в ВИНТИ 9 янв. 1980 г., № 158-80 Деп.

49. Исследование процесса эпитаксии слоев полупроводниковых материалов в поле гамма-излучения / Е. М. Курицын, В. А. Мокрицкий, Б. А. Данильченко, В. И. Шеховцов ; АН УССР, Ин-т физики. – Киев, 1980. – 19 с. – Библиогр.: 7 назв.

50. *Эпитаксия слоев в поле гамма-облучения / Е. М. Курицин, В. И. Шеховцов, В. А. Мокрицкий // Материалы 2-го Всесоюз. совещ. по глубоким уровням в полупроводниках. – Ташкент, 1980.

51. *Эпитаксия слоев германия из жидкой фазы в поле гамма-облучения / В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицын, Б. А. Данильченко, В. И. Шеховцов // Рост из расплавов и высокотемператур. растворов : тез. докл. VI Междунар. конф. по росту кристаллов, 10–16 сент. 1980 г. – [Б. м.], 1980. – [Т. III]. – С. 396.

1981

52. *Влияние радиации на растворимость полупроводников / В. А. Мокрицкий // Письма в ЖЭТФ. – 1981. – Т. 7, № 17.

53. *Гетероэпитаксия слоев соединений АЗВ5 из жидкой фазы / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, А. И. Казаков // Материалы Всесоюз. конф. по физике соединений АЗВ5. – Новосибирск, 1981.

54. Жидкофазная эпитаксия слоев арсенида галлия в радиационном поле / В. А. Мокрицкий, Е.М. Курицын // Электрон. техника. Сер. : Материалы. — Вып. 4 (153). – М., 1981. – С. 22–23.

55. *Закономерности управления структурными свойствами слоев при жидкофазной эпитаксии / В. А. Мокрицкий // Электрон. техника. Сер. : Материалы. – М., 1981. – № 6.

56. Исследование физико-химических процессов жидкофазной эпитаксии и разработка способов управления свойствами слоев на примере элементарных полупроводников и соединений типа АЗВ5 : дис. ... д-ра техн. наук : специальность 05.16.07 – Металлургия металлов высокой чистоты и прециз. сплавов / В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1981. – 507 с. – Библиогр.: 7 назв.

1982

57. Воздействие акустических пристеночных течений на процесс очистки полупроводниковых подложек / В. А. Мокрицкий, П. Н. Белецкий, Т. Н. Куброва, П. Хоппе, В. И. Цацко // Акустика и ультразвуковая техника : респ. межвед. науч.-техн. сб. – Киев, 1982. – Вып. 17. – С. 20–25. – Библиогр.: 7 назв.

58. *Исследование массопереноса в жидкой фазе при эпитаксии слоев полупроводников путем принудительного охлаждения раствора-расплава / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, И. В. Даховский, А. А. Литвин // Тез. докл. VI Всесоюз. конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск, 1982.

59. *Кинетика роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов из жидкой фазы / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Литвин // Тез. докл. VI Всесоюз. конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск, 1982.

60. *Особенности роста эпитаксиальных слоев арсенида галлия в поле гамма-излучения / В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицын // Тез. докл. VI Всесоюз. конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. — Новосибирск, 1982. – С. 117–118.

61. Эпитаксия слоев в радиационном поле / Б. А. Данильченко, Е. М. Курицын, В. А. Мокрицкий, В. И. Шеховцов // Укр. физ. журн. – 1982. – Т. 27, № 4. – С. 572–575. – Библиогр.: 6 назв.

1984

62. Использование биений для повышения точности измерения действующего значения напряжения в диапазоне инфразвуковых частот методом сравнения / В. А. Мокрицкий // Метрол. обеспечение динам. измерений в ИИС. – Львов, 1984. – С. 76–82.

63. Исследование свойств арсенида галлия для изготовления прозрачных в ИК-диапазоне окон : этапы Т_А, Т_Б, Т_В : техн. информ. / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1984. – 20 с.

64. *Управление качеством структуры эпитаксиальных слоев соединений типа АЗВ5 / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, В. С. Шобик // II Всесоюз. конф. по физике и технологии тонких пленок – Ивано-Франковск, 1984. – Ч. 1.

1985

65. *Анализ термодинамической устойчивости твердых растворов в системе КРТ / В. А. Мокрицкий, А. И. Казаков, И. Н. Кишмар // Тр. VII респ. семинара по физике и технологии тонких пленок. – Ивано-Франковск, 1985.

66. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Микроэлектроника и микросхемотехника» для студентов специальности 0612 / сост. : В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т, Каф. конструирования и пр-ва радиоаппаратуры. – Одесса, 1985. – 40 с.

67. Методические указания к практическим занятиям по курсу «Физические основы электронной техники» для студентов специальности 0612 / сост. : В. А. Мокрицкий, В. С. Шобик ; Одес. политехн. ин-т, Каф. конструирования и пр-ва радиоаппаратуры. – Одесса, 1985. – 47 с. – Библиогр.: 7 назв.

68. *Процессы растворения и роста кристаллов полупроводников при воздействии излучений / В. А. Мокрицкий // Материалы VI Всесоюз. конф. по росту кристаллов. – 1985. – Т. 3. – С. 115.

69. Расчет положения областей термодинамической неустойчивости для твердой фазы систем тела АхВуСi-х-у Д (АвхСуДi-х-у) / В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1985. – 19 с. – Деп. в УкрНИИТИ 31.07.85, № 16247к-85Деп.

70. *Рост слоев полупроводников в условиях свободной конвекции / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, И. В. Даховский, А. А. Литвин // Теорет. основы хим. технологии. – 1985. – Т. 19, № 5.

1986

71. *Кинетика роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных растворов из жидкой фазы / В. А. Мокрицкий, А. А. Литвин, С. Н. Дранчук // Тр. VII Всесоюз. конф. по процессам роста и синтеза полупроводниковых кристаллов и пленок. – Новосибирск, 1986. – Т. 2.

72. Методические указания к решению задач по дисциплине «Физические основы электронной техники» для студентов специальности 0612 / Одес. политехн. ин-т, Каф. конструирования и пр-ва радиоаппаратуры ; сост. : В. А. Мокрицкий, Б. С. Шобик. – Одесса, 1986. – 35 с. – Библиогр.: 4 назв.

73. *Моделирование процессов жидкофазной эпитаксии для служебного пользования / С. Н. Дранчук, В. С. Шобик, В. А. Мокрицкий // Тр. Всесоюз. шк. по термодинамике и технологии полупроводниковых кристаллов. – Ивано-Франковск, 1986.

1987

74. *Исследование по теории процессов управления свойствами кристаллов и слоев / С. Н. Дранчук, В. А. Мокрицкий, Н. Каримов, К. Умурзаков. – Ташкент : ФАН, 1987. – 56 с.

75. Механизмы массопереноса вещества при жидкофазной эпитаксии слоев / С. Н. Дранчук, А. А. Литвин, В. А. Мокрицкий // Теорет. основы хим. технологии. – 1987. – № 2. – С. 247–250.

76. Программа, методические указания и контрольные работы по курсу «Микроэлектроника и микросхемотехника» для студентов специальности 0612 / Одес. политехн. ин-т. ; сост. : В. А. Мокрицкий, В. С. Шобик. – Одесса, 1987. – 27 с.

77. Расчет фазовых равновесий в многокомпонентных системах / А. И. Казаков, В. А. Мокрицкий, В. Н. Романенко, Л. Хитова ; под ред. В. Н. Романенко. – М. : Металлургия, 1987. – 136 с.

78. Термодинамический анализ процессов роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов в условиях принудительного охлаждения насыщенного раствора-расплава / В. А. Мокрицкий, Н. А. Васькова, С. Н. Дранчук ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1987. – Деп. в ГАСНТИ 20.02.87, № 807-У.

1988

79. Влияние пересыщения раствора на структурное совершенство эпитаксиальных слоев / С. Н. Дранчук, А. Н. Крижановский, А. А. Литвин, В. А. Мокрицкий, А. М. Тузовский, В. С. Шобик // Теорет. основы хим. технологии. – 1988. – Т 2. – С. 265.

80. Моделирование процессов роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов из переохлажденного раствора-расплава / В. А. Мокрицкий, Н. А. Васькова С. Н. Дранчук. – М., 1989 – №1. – Деп. в ВИНТИ, Деп. 12.09.88, №2111-Ук88.

81. Повышение точности компарирования напряжений в области инфразвуковых частот путем оптимального выбора частоты опорной величины / А. Г. Дорош, В. А. Мокрицкий ; ВНИИ метрол. измерит. и упр. систем. – Львов, 1988. – 14 с. – Библиогр.: 7 назв. – Деп. в ВНИИКИ 22.04.88, № 473-кк88.

82. Повышение точности передачи размера Вольта напряжения постоянного тока напряжению инфразвуковой частоты / В. А. Мокрицкий ; ВНИИ метрол. измерит. и упр. систем. – Львов, 1988. – 23 с. – Библиогр.: 10 назв. – Деп. в ВНИИКИ 22.04.88, № 474-кк88.

1989

83. Анализ диффузионных процессов при жидкофазной эпитаксии / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук. – М., 1989. – №7. – Деп. в ВИНТИ 6.03.89, №697-Ук89.

84. *Гетероэпитаксия слоев соединений из жидкой фазы на подложках из элементарных полупроводников / В. С. Шобик, В. А. Мокрицкий. – М., 1989. – № 4. – Деп. ИНХ СО СССР 9.01.89.

85. Методические указания к лабораторным работам по курсу «Микроэлектроника и микросхемотехника» для студентов специальности 20.05 / Одес. политехн. ин-т ; сост. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1989. – 44 с.

86. *Моделирование процессов роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов из переохлажденного раствора-расплава / В. А. Мокрицкий, Н. А. Васькова, С. Н. Дранчук. – М., 1989. – № 1. – Деп. в ВИНТИ № 2111-Ук88 от 12.09.88.

87. *Приближение Пфана и диффузионные процессы в расплавах / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук // Электрон. техника. Сер. : Материалы. – М., 1989. – № 7.

1990

88. *Анализ кинетики эпитаксии твердых растворов / С. Н. Дранчук, В. А. Мокрицкий // Физ.-хим. свойства многокомпонент. полупроводниковых систем. Эксперимент и моделирование : тр. Всесоюз. семинара. – Одесса-Новочеркасск, 1990.

89. Методические указания, программа и контрольные работы по курсу «Микроэлектроника и микросхемотехника». Раздел «Микроэлектроника» для студентов специальности 20.05 / Одес. политехн. ин-т ; сост. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1990. – 36 с.

1992

90. Измерение температуры по фазовому сдвигу лазерного излучения / В. А. Мокрицкий, А. С. Гаркавенко, В. В. Календин // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 1992. – № 4. – С. 50–51. – Библиогр.: 3 назв.

1993

91. Формирование омических контактов на поверхности полупроводниковых соединений / В. А. Мокрицкий, А. С. Гаркавенко, П. С. Кособуцкий // Технология и конструирование электрон. аппаратуры. – 1993. – № 2. – С. 40–41.

1994

92. *Влияние радиационного облучения на свойства высокотемпературной керамики (ВТСП) / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, А. А. Савельев // Материалы 49-й област. науч.-техн. конф. – Одесса, 1994.

93. Воздействие ионизирующих излучений на материалы электронной техники / В. А. Мокрицкий, А. О. Матковский, Д. Ю. Сугак, С. Б. Убизский ; под ред. проф. А. О. Матковского. – Львів : Світ, 1994. – 211 с.

1995

94. Принципы радиационного управления свойствами полупроводников / С. Н. Дранчук, В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицын // Тр. Одес. политехн. ун-та : семидесятипятилетию ун-та посвящ. – Одесса, 1995. – С. 138–140. – Библиогр.: 3 назв.

95. Расчет коэффициента поглощения ИК-излучения свободными носителями заряда в полупроводниках / В. А. Мокрицкий, А. С. Гаркавенко // Технология

и конструирование в электрон. аппаратуре. – 1995. – № 1. – С. 36–37. – Библиогр.: 7 назв.

1996

96. Воздействие малых доз радиационного излучения на свойства керамики Y-Ba-Cu-O (1-2-3) / В. А. Мокрицкий, А. А. Савельев, С. Н. Дранчук // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1996. – № 2. – С. 46–47. – Библиогр.: 3 назв.

97. Современные технологии обеспечения надежности радиоэлектронной аппаратуры на этапах проектирования и производства / В. А. Мокрицкий, С. В. Ленков, В. В. Зубарев [и др.] ; Ин-т проблем крит. технологий и надежности радиоэлектроники. – Киев, 1996. – Деп. в УкрИНТЭИ 12.12.96, № 254-УК96.

1997

98. *Моделирование воздействия нейтронного облучения на структуру кристаллической решетки керамики Y-Ba-Cu-O / В. А. Мокрицкий, А. А. Савельев // Придніпр. наук. вісн. Машинобуд. та техн. науки. – 1997. – № 53 (64).

99. Расчет объемов выборок для определения причин отказов электрорадиоизделий в составе РЭА / В. А. Мокрицкий, С. В. Ленков, В. В. Зубарев, З. А. Фишер, А. А. Савельев // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 1997. – № 3. – С. 29–31.

1998

100. Вплив малих доз опромінювання швидкими нейтронами та електронами на температурну залежність опору кераміки $YBa_2Cu_3O_{7-x}$ / В. А. Мокрицький, А. А. Савельєв // Укр. фіз. журн. – 1998. – Т. 43, № 1. – С. 112–115. – Бібліогр.: 3 назви.

101. Исследования концентрационных зависимостей тонкопленочных электролюминесцентных структур на основе ZnS HoF₃ / В. А. Мокрицкий, В. В. Жеревчук, О. В. Поляруш // Придніпр. наук. вісн. Машинобуд. та техн. науки. – 1998. – № 26 (93). – С. 14–17.

102. Почему мы будем голосовать за избрание в Верховную Раду Украины Плавича Владимира Петрович / В. А. Мокрицкий, А. И. Казаков, С. С. Стриженюк, В. П. Гроза, Ю. Ю. Онищенко // Веч. Одесса. – 1998. – 28 февр.

1999

103. Методика оценки эффективности применения индикаторов различных типов в бортовых средствах отображения информации / В. В. Зубарев, В. А. Мокрицкий, О. В. Поляруш, А. Н. Перегудов // Вісн. Нац. авіац. ун-ту. – 1999. – № 1. – С. 108–113.

104. Методы улучшения характеристик тонкопленочных электролюминесцентных структур / В. А. Мокрицкий, В. В. Жеревчук, А. В. Андриянов // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1999. – Вып. 2 (8). – С. 202–205. – Библиогр.: 5 назв

105. Получение и исследование свойств прозрачных токопроводящих пленок для элементов опто- и микроэлектроники / В. А. Мокрицкий, А. А. Савельев, В. А. Бойко, О. В. Поляруш // Оптимизация упр., информ. системы и компьютер. технологии : тр. Укр. акад. экон. кибернетики (ЮНЦ). – Киев ; Одесса, 1999. – Вып. 1, Ч. 1. – С. 248–251.

106. Технология получения легированных алмазоподобных пленок / В. А. Мокрицкий, С. М. Ротнер, С. В. Завьялов // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 1999. – Вып. 3 (9). – С. 183–186. – Библиогр.: 3 назв

2000

107. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і виробництво пристроїв автоматики» для студентів фаху 7.091401 / уклад. : В. А. Мокрицький, В. С. Миронов. – Одеса : ОДПУ, 2000. – 78 с.

108. Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Матеріали електронної техніки та технологічні основи електроніки» для студентів спеціальності 7.090805 / уклад. : С. М. Дранчук, В. А. Мокрицький. – Одеса, 2000. – 85 с.

109. Повышение разрешающей способности металлографических исследований многослойных полупроводниковых систем / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, В. А. Завадский // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2000. – Вып. 1 (10). – С. 175–177. – Библиогр.: 7 назв.

110. Радиационная технология управления параметрами элементов и микросхем частного применения / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский // Современ. информ. и электрон. технологии : тр. Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 23–26 мая 2000 г. – Одесса, 2000. – С. 81–82.

111. Технология получения легированных алмазоподобных пленок / В. А. Мокрицкий, С. М. Ротнер, С. В. Завьялов // Металлургия : сборник. – Запорожье, 2000. – Вып. 3. – С. 50–52. – Библиогр.: 2 назв.

2001

112. *Алмазоподобные пленки в микроэлектронике / С. М. Ротнер, В. А. Мокрицкий // Тонкие пленки в электронике : сб. докл. 12 Междунар. симп., г. Харьков, 23–27 апр. 2001 г. – Харьков, 2001.
113. *Безконтактна багатокомпозиційна інформаційно-вимірювальна система / В. А. Мокрицький, Д. В. Бойко, С. В. Ленков, І. В. Огар // Тр. Міжнар. наук.-техн. конф. «Політ-2001». – Київ, 2001.
114. Влияние радиационного облучения на характеристики солнечных элементов из поликристаллического кремния / В. А. Завадский, Б. П. Масенко // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2001. – № 4-5. – С. 47–48. – Бібліогр.: 4 назв.
115. Влияние радиационной обработки на параметры интегральных преобразователей температуры / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2001. – № 1. – С. 25–27. – Библиогр.: 3 назв.
116. *Залежність діелектричної проникливості композитів для авіаційної техніки від параметрів їх компонентів / В. А. Мокрицький, М. В. Дмитрієв, В. В. Зубарєв, Д. В. Лукомський, Д. К. Огар // АВІА-2001 : пр. III Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ, 2001.
117. *Знешкодження джерел іонного забруднення, як один з шляхів забезпечення стабільності напівпровідникових приладів / Д. В. Лукомський, В. А. Мокрицький, Д. К. Огар, І. В. Огар // АВІА-2001 : пр. III Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ, 2001.
118. *Микроэлектронные датчики температуры в измерительных системах / Д. В. Бойко, С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий, И. В. Огарь // АВІА-2001 : пр. III Міжнар. наук.-техн. конф. – Київ, 2001.
119. Модифицированный фосфид галлия для лазеров и мощных светодиодов / Л. С. Гаркавенко, В. А. Мокрицкий // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2001. – № 2. – С. 54–55.
120. Обработка монокристаллов CdZnFe для применения в датчиках гамма-излучения / В. А. Мокрицкий, С. В. Ленков, О. В. Маслов, С. А. Савельев // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2001. – № 3. – С. 9–10.
121. *Повышение экономической эффективности производства ИК-фотопреобразователей / В. А. Мокрицкий, Д. К. Огарь, И. В. Огарь //

Экономико-правовые проблемы и менеджмент нетрадиц. энергетики : тр. Междунар. науч.-практ. конф. – Херсон, 2001.

122. *Пути повышения экономичности производства кремниевых солнечных преобразователей / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, Б. П. Масенко // Экономико-правовые проблемы и менеджмент нетрадиц. энергетики : тр. Междунар. науч.-практ. конф. – Херсон, 2001.

123. Радиационная обработка ИК-фотоприемников на основе CdHgTe / В. А. Завадский, В. В. Зубарев, В. А. Мокрицкий // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2001. – № 3. – С. 4–5. – Библиогр.: 5 назв.

124. *Радіаційна стійкість виробів електронної техніки / В. В. Зубарев, В. А. Мокрицький, В. А. Завадський, А. О. Савельєв // Тр. 2 Междунар. науч.-техн. конф. – Одеса, 2001.

125. *Свойства монокристаллов CdZnTe для датчиков гамма-излучения / С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, С. А. Савельев // Тр. 2 Междунар. науч.-техн. конф. – Одеса, 2001.

126. Свойства эпитаксиальных слоев германия при облучении быстрыми электронами / Е. М. Курицын, В. А. Мокрицкий, А. А. Савельев // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2001. – Вып. 1 (13). – С. 148–151. – Библиогр.: 5 назв.

2002

127. *Влияние ионизирующих излучений на параметры и свойства оптических полупроводниковых и температурно-преобразовательных элементов / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, С. В. Ленков, Д. В. Лукомский // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2002. – № 3.

128. Влияние облучения быстрыми нейтронами на эпитаксиальный арсенид галлия / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, С. В. Ленков, Д. В. Лукомский // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2002. – № 6. – С. 7–9. – Библиогр.: 7 назв.

129. Возникновение помех в измерительных цепях авиационной РЭА и способы борьбы с ними / В. А. Мокрицкий, Г. С. Ранченко, В. М. Грудинкин // Пр. УНДІРТ. – 2002. – № 2 (30). – С. 21–23. – Библиогр.: 2 назв.

130. Новые лазерные методы, средства и технологии : монография / А. С. Гаркавенко, В. В. Зубарев, С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий,

Д. В. Лукомский. – Одесса : Изд-во УТС-ПРИНТ, 2002. – 279 с. : ил. – Библиогр.: 197 назв.

131. Радіаційна модифікація параметрів та вивчення стійкості напівпровідникових виробів електронної техніки для космічної апаратури / В. В. Зубарев, В. А. Мокрицький, Р. М. Салімов, А. В. Савельєв // Нац. акад. оборони України : пр. акад. – Київ, 2002. – № 39. – С. 293–294.

132. Радиационное управление свойствами полупроводников / В. А. Завадский, В. А. Мокрицкий // 1-а Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнар. участю), м. Одеса, 10–14 верес. 2002 р. : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 2 : Стенд доп. – С. 281. – Библиогр.: 4 назв.

133. Радиационное управление свойствами материалов и изделий опто- и микроэлектроники / С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий, А. С. Гаркавенко, В. В. Зубарев, В. А. Завадский. – Одесса : Друк, 2002. – 297 с.

134. *Современные радиационные технологии в управлении параметрами ИЭТ / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, С. В. Ленков, Д. В. Лукомский // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2002. – № 3.

135. Увеличение растворимости кристаллов полупроводников под воздействием ионизирующего излучения / В. А. Мокрицкий // 1-а Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнар. участю), м. Одеса, 10–14 верес. 2002 р. : тези доп. / Наук. рада з проблеми «Фізика напівпровідників», НАН України, МОН України [та ін.] – Одеса, 2002. – Т. 1 : Пленар. та усні секц. доп. – С. 150.

136. Физико-технические основы радиационной технологии полупроводников / В. А. Мокрицкий, С. В. Ленков, Д. А. Перегудов, Г. Т. Тариелашвили ; под ред. В. А. Мокрицкого. – Одесса : Астропринт, 2002. – 300 с. – (Соврем. квантовые и корпускуляр. технологии). – Библиогр.: 111 назв.

137. Фізико-технічні основи мікроелектроніки : підручник / В. А. Мокрицький, С. М. Дранчук, О. В. Андріянов, С. В. Ленков, В. В. Зубарев. – Одесса : ТЕС, 2002. – 712 с.

138. *Электротехнические элементы на основе алмазоподобных пленок / С. М. Ротнер, В. А. Мокрицкий, В. Э. Никитин // Тонкие пленки в электронике : сб. докл. 12 междунар. симп. – Харьков, 2002.

139. Эпитаксия слоев полупроводников в поле гамма-излучения / Е. М. Курицын, С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий // 1-а Укр. наук. конф. з

фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнар. участю), м. Одеса, 10–14 верес. 2002 р. : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 2 : Стенд доп. – С. 292.

2003

140. *Влияние облучения и термоциклирования на параметры и свойства оптических полупроводниковых элементов / В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, С. В. Ленков, Д. В. Лукомский // Фотоэлектроника. – 2003. – № 12.

141. Вплив дефектів функціональних матеріалів на надійність електроніки / В. В. Зубарев, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, Д. О. Перегудов ; під. ред. С. В. Ленкова. – Одеса : Друк, 2003. – 452 с. – Бібліогр.: 84 назви. – (Високі технології електроніки).

142. Вплив дефектів функціональних матеріалів на надійність електроніки / В. А. Мокрицький, В. В. Зубарев, С. В. Ленков, Д. О. Перегудов. – Одеса : Друк, 2003. – 452 с. – Бібліогр.: 84 назви.

143. Радіаційно-термічне корегування властивостей арсеніду галію / С. В. Ленков, Д. В. Лукомський, В. А. Мокрицький [та ін.] // Вісн. НАУ. – 2003. – № 1 (16). – С. 70–72.

144. Радиационное легирование сульфида кадмия и арсенида галлия / В. А. Мокрицкий А. С. Гаркавенко, В. В. Зубарев, С. В. Ленков // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2003. – № 6. – С. 14–17. – Библиогр.: 7 назв.

2004

145. Датчики гамма-излучения на основе соединения кадмий-цинк-теллур (КЦТ) / М. В. Максимов, О. В. Маслов, В. А. Мокрицкий, Ю. М. Николаенко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМЕСТ-1, м. Одеса, 1–5 черв. 2004 р. : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. / НАН України, М-во пром. політики України, МОН України [та ін.]. – Одеса, 2004. – С. 147.

146. До механізму виникнення дефектів структури напівпровідників / В. А. Завадський, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький // Соврем. информ. и электрон. технологии : тр. V междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 17–21 мая 2004 г. / М-во пром. политики Украины, МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т [и др.]. – Одеса, 2004. – С. 278. – Бібліогр.: 3 назви.

147. Епітаксія матеріалів оптоелектроніки / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, С. М. Дранчук, В. В. Зубарев, В. С. Шобік. – Одеса : Друк, 2004. – 397 с. – Бібліогр.: 207 назв.

148. Материалы и условия эксплуатации датчиков ИК-излучений / В. А. Мокрицкий, В. В. Зубарев, В. А. Завадский // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМЕСТ-1, м. Одеса, 1–5 черв. 2004 р. : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. – Одеса, 2004. – С. 308.

149. Свойства легированных углеродных (алмазоподобных) пленок / С. М. Ротнер, В. А. Мокрицкий, С. В. Грасовский // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2004. – Вып. 2 (22). – С. 1–4.

150. Управление свойствами халькогенидных стеклообразных полупроводников для сенсоров памяти / С. А. Жуков, С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМЕСТ-1, м. Одеса, 1–5 черв. 2004 р. : тези доп. Міжнар. наук.-техн. конф. – Одеса, 2004. – С. 239.

151. Эпитаксия слоев полупроводников в поле гамма-излучения / Е. М. Курицын, С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий // 1-а Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників УНКФН-1 (з міжнар. участю), м. Одеса, 10–14 верес. 2002 р. : тези доп. – Одеса, 2002. – Т. 2 : Стенд. доп. – С. 292.

2005

152. Блок детектирования гамма-излучения на основе CdZnTe для систем радиационного контроля / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, Ю. Е. Николаенко, М. В. Максимов // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2005. – № 3. – С. 15–17. – Библиогр.: 5 назв.

153. Дослідження впливу конструктивних дефектів на властивості кремнієвих фотоелектричних перетворювачів / Д. В. Лукомський, С. В. Ленков, Я. І. Лепіх, В. А. Мокрицький, С. В. Монаков // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології / Одес. нац. ун-т. – 2005. – № 4. – С. 47–54. – Бібліогр.: 10 назв

154. Методика и средства контроля технического состояния цифровых приборов, содержащих элементы с обратными связями / С. В. Ленков, П. А. Савков, В. А. Мокрицкий, С. В. Гахович, Н. Н. Захрабов // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2005. – № 4. – С. 61–65. – Библиогр.: 4 назв.

155. Оптоелектроніка інфрачервоного діапазону : матеріали, прилади, системи / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, О. І. Ликов, В. В. Зубарев – Одеса : ЦУПЛ Поліграф, 2005. – 356 с.

156. *Радіаційна стійкість гібридних інтегральних мікросхем / С. В. Ленков, А. І. Ликов, В. А. Мокрицький // Наук.-практ. конф. пам'яті С. А. Жукова. – Київ, 2005.

2006

157. Дослідження термопружного механізму впливу високоенергетичного електронного пучка на досконалість напівпровідникових кристалів / С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, Д. В. Лукомський, В. В. Видолоб // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 65–71.

158. *Електролюмінесценція багатокомпонентних матеріалів типу А2В6 / О. В. Андріянов, А. І. Казаков, В. А. Мокрицький, В. С. Міронов // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМЕСТ-2 : друга Міжнар. наук.-техн. конф. – Одеса, 2006.

159. Лазери в метрології напівпровідників / В. В. Видолоб, Р. С. Гаркавенко, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький ; Одес. нац. політехн. ун-т. – Одеса : Поліграф, 2006. – 270 с. – Бібліогр.: 266 назв.

160. Методика отримання і електричні властивості алмазоподібних плівок / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, С. М. Ротнер, С. В. Грасовський // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2006. – Вип. 4. – С. 85–87.

161. *Модель деградації ІЧ фотоприймачів / С. В. Ленков, В. А. Мокрицький // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології СЕМЕСТ-2 : друга Міжнар. наук.-техн. конф. – Одеса, 2006.

162. Мощные резисторы нового поколения на основе углеродных (алмазоподобных) пленок / С. М. Ротнер, В. А. Мокрицький, В. В. Лагутин, Ю. С. Медведенко // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2006. – № 6. – С. 58–60. – Библиогр.: 3 назв.

163. Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням / О. С. Гаркавенко, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, О. С. Пашков. – Одеса : ПОЛІГРАФ, 2006. – Т. 1 : Механізм генерації, властивості випромінювання. – 434 с. : іл. – Бібліогр.: 432 назви.

164. Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням / О. С. Гаркавенко, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, В. В. Видолоб. – Одеса : ПОЛІГРАФ, 2006. – Т. 2 : Активні середовища. Розробка приладів. – 392 с. : іл. – Бібліогр.: 456 назв.

165. Принципы применения CO₂-лазера в интерферометрии / В. А. Мокрицький, А. С. Гаркавенко, С. В. Ленков // Современ. информ. и

електрон. технології : тр. сьомої Міжнарод. науч.-практ. конф., г. Одеса, 22–26 мая 2006. – Одеса, 2006. – Т. 2. – С. 147.

166. Свойства легированных углеродных (алмазоподобных) пленок / С. М. Ротнер, В. А. Мокрицкий, С. В. Грасовский // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одеса, 2006. – Вып. 2 (26). – С. 122–125. – Библиогр.: 3 назв.

167. Фізичні основи мікро- та наноелектроніки : навч. посіб. / В. А. Мокрицький, О. В. Андріянов. – Одеса : Наука і техніка, 2006. – 40 с.

168. Щодо удосконалення напівпровідникових лазерів з електронним накачуванням / В. А. Мокрицький, О. С. Пашков, В. В. Видолоб // Сучас. напрямки розвитку сухопут. військ Збройних Сил України : матеріали міжвуз. наук.-практ. конф. – Одеса, 2006. – С. 61.

2007

169. *Багатоелементні лазери на основі сполук A_2B_6 , A_3B_5 / В. В. Видолоб, В. В. Ленков, В. А. Мокрицький, О. С. Пашков // Соврем. информ. и электрон. технологии. – Одеса, 2007.

170. Властивості оптичних вікон для сенсорів ІЧ-діапазону / В. А. Мокрицький, Я. І. Лепіх, О. С. Пашков // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2007. – № 1. – С. 35–37.

171. *Вплив інтенсивних пучків електронів на характеристики напівпровідникових лазерів / В. В. Видолоб, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, О. С. Пашков // 3-я Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників. – Одеса, 2007.

172. *Деградація лазерів на основі багатокомпонентних напівпровідникових сполук / В. А. Прохоров, В. А. Мокрицький // Датчики, прилади, системи : матеріали конф. – Гурзуф, 2007.

173. *Особливості виготовлення мішеней лазерів на основі халькогенідів свинцю / В. А. Мокрицький, В. А. Прохоров // Датчики, прилади, системи : матеріали конф. – Гурзуф, 2007.

174 Система оптического контроля деформаций торцовой поверхности резьбовых деталей при затяжке / В. А. Мокрицкий, В. А. Анисимов, А. Н. Куценко, В. В. Тищенко, А. С. Шереметиков // Вісн. Черкас. держ. технол. ун-ту. – 2007. – Спец. вип. – С. 158–160.

175. *Тонкоплівкові електро-люмінісцентні датчики температури у НВЧ полях / О. В. Андріянов, А. І. Казаков, В. А. Мокрицький // 111 Укр. наук. конф. з фізики напівпровідників. – Одеса, 2007.

176. Влияние быстрых электронов на свойства эпитаксиальных слоев кремния и параметры фоторезисторов на их основе / В. А. Мокрицкий, Я. И. Лепих, Е. М. Курицын, О. В. Банзак // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2008. – № 3. – С. 34–39. – Библиогр.: 5 назв.
177. Воздействие ионизирующих излучений на параметры полупроводниковых оптических элементов / В. А. Мокрицкий, А. В. Селюков, О. В. Банзак // Датчики, прилади та системи : міжнар. наук.-техн. конф. – Черкаси–Гурзуф, 2008. – С. 160.
178. Дослідження властивостей шарів фосфіду галія після імплантації домішок / В. А. Мокрицький, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 12. – С. 70–73.
179. Исследование радиационной стойкости гибридных интегральных микросхем / О. В. Банзак, В. П. Волосевич, В. А. Мокрицкий // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2008. – № 4 (76). – С. 14–15.
180. Исследование радиационной стойкости гибридных интегральных микросхем / В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, В. П. Волосевич // Современ. информ. и электрон. технологии : тр. девятой Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 19–23 мая 2008 г. (СИЭТ – 2008) / МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т. – Одесса, 2008. – Т. 2. – С. 118. – Библиогр.: 1 назв.
181. Методи покращення ефективності напівпровідникових фотоприймачів ІЧ-випромінювання / В. А. Мокрицький, О. В. Банзак, О. В. Селюков // Тр. Одес. политехн. ун-та. – Одесса, 2008. – Вып. 2 (30). – С. 189–193. – Библиогр.: 5 назв.
182. Моделирование термодинамической стабильности полупроводниковых твердых растворов с неоднородным распределением состава / А. И. Казаков, В. А. Мокрицкий, Д. К. Петров // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-4), м. Одеса, 2–6 черв. 2008 р. : тези доп. 3-ої Міжнар. наук.-техн. конф. – Одеса, 2008. – С. 197.
183. Радіаційне легування сульфїду кадмію / В. А. Мокрицький, О. В. Банзак, М. М. Охрамович, Л. О. Ряба // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2008. – Вип. 11. – С. 42–45.
184. Радиационная модификация свойств кремниевых транзисторов / В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак // Матеріали електрон. техніки та сучас. інформ. технології : матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф. – Кременчук, 2008. – С. 70–71.

185. Радиационная модификация свойств кремниевых транзисторов / В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицын, О. В. Банзак // Нові технології. – Кременчук, 2008. – № 3. – С. 20–23.

186. Радиационная стойкость кремниевых датчиков ИК-излучения / В. А. Мокрицкий, Е. М. Курицын, О. В. Банзак // Сенсорна електроніка та мікросистемні технології (СЕМСТ-4), м. Одеса, 2–6 черв. 2008 р. : тези доп. 3-ої Міжнар. наук.-техн. конф. – Одеса, 2008. – С. 362.

187. Радиационное легирование арсенида галлия / В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, В. П. Волосевич, М. Н. Охрамович // Вісн. інженер. акад. України. – Київ, 2008. – № 1. – С. 219 – 220.

2009

188. Вплив іонізуючих випромінювань на епітаксійні шари фосфіду галія / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, О. В. Банзак, Ю. О. Гунченко, О. С. Пашков // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 21. – С. 73–75.

189. Дослідження радіаційної модифікації первинних перетворювачів температури / В. А. Мокрицький, О. В. Банзак, М. М. Охрамович // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 20. – С. 87–90.

190. Исследование деформации торцевой поверхности болта методом оптической голографической интерферометрии / В. А. Анисимов, А. Н. Куценко // Електромашинобуд. та електрообладнання : міжвід. наук.-техн. зб. : присвяч. 45-річчю Ін-ту комп'ютер. систем / Одес. нац. політехн. ун-т. – Київ, 2009. – Вип. 72 : Комп'ютер. системи та мережі. – С. 246–255.

191. Класифікація і порівняльна оцінка індикаторів для пристроїв відображення інформації / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, Ю. О. Гунченко, О. В. Банзак, О. С. Пашков // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 22. – С. 59–63.

192. Метод керування характеристиками акустооптичних пристроїв / Я. І. Лепіх, В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, Ю. О. Гордієнко, А. О. Дружинін // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2009. – Вип. 24. – С. 58–62.

193. Моделирование критических явлений в функциональных материалах микроэлектроники с использованием теории катастроф / А. И. Казаков, В. А. Мокрицкий, Е. Н. Давлетов // Соврем. информ. и электрон. технологии : тр. десятой Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 18–22 мая 2009 г. – Одесса, 2009. – Т. II. – С. 86. – Библиогр.: 2 назв.

194. Напівпровідникові та акустoeлектронні оптичні сенсори і системи : монографія / Я. І. Лепіх, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький [та ін.] ; за ред. С. В. Ленкова, В. А. Мокрицького. – Одеса : Астропринт, 2009. – 256 с. – Бібліогр.: 60 назв.

195. *Основи проектування інтегральних схем : навч. посіб. / О. В. Андріянов, В. А. Мокрицький. – Одеса : Наука і техніка, 2009.

196. Сравнительный анализ влияния быстрых электронов и нейтронов на эпитаксиальные слои арсенида галлия / О. В. Банзак, В. А. Мокрицкий, В. А. Завадский, С. В. Ленков, Я. И. Лепих // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2009. – № 4. – С. 51–54. – Библиогр.: 3 назв.

197. Узагальнений комплексний показник якості кремнієвих фотоелектронних перетворювачів для апаратури спеціального призначення / С. В. Ленков, Я. І. Лепіх, В. А. Мокрицький, Д. В. Лукомський, М. М. Охрамович // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2009. – № 4. – С. 44–50.

198. Физические принципы радиационной модификации приборов твердотельной электроники / В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, В. П. Волосевич // Соврем. информ. и электрон. технологии : тр. десятой Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса, 2009. – Т. 2. – С. 114.

2010

199. Влияние гамма-облучения на основные параметры фоторезисторов на основе Cd-Hg-Te / В. А. Мокрицкий, С. В. Ленков, О. В. Банзак, Ю. А. Гунченко // Соврем. информ. и электрон. технологии (СИЭТ-2010) : тр. XI Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 24–28 мая 2010 г. – Одесса, 2010. – Т. 2. – С. 109. – Библиогр.: 2 назв.

200. Засоби підвищення ефективності оптоелектронних МДН приладів / С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, Ю. О. Гунченко, О. В. Банзак // Соврем. информ. и электрон. технологии (СИЭТ-2010): тр. XI Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 24–28 мая 2010 г. / М-во пром. политики Украины, МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т. – Одесса, 2010. – Т. 2. – С. 111. – Бібліогр.: 3 назви.

201. *Лазерные диоды на основе твердого раствора индий-галлий-мышьяк-фосфор / С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, Ю. А. Гунченко // Війс. освіта та наука: сьогодні та майбутнє : VI Міжнар. наук.-практ. конф., м Київ, 25 лист. 2010 р. – Київ, 2010.

202. Математична модель системи математичного регулювання перетворювачем електроенергії / С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, Г. О. Гунченко, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 27. – С. 53–56.
203. Метод керування характеристиками акустооптичних пристроїв / Я. І. Лепіх, С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, Ю. О. Гордієнко, А. О. Дружинін // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 24. – С. 58–62.
204. Моделирование стабильности многокомпонентных неомогенных полупроводниковых материалов с использованием теории катастроф / А. И. Казаков, В. А. Мокрицкий, Е. Н. Давлетов // Современ. информ. и электрон. технологии (СИЭТ-2010) : тр. XI Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 24–28 мая 2010 г. – Одесса, 2010. – Т. 2. – С. 135. – Библиогр.: 3 назв.
205. Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона / С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий, А. С. Гаркавенко // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – 2010. – № 24–25. – С. 18–21.
206. Оптимізація умов експлуатації напівпровідникових лазерів з електронною накачкою енергії / С. В. Ленков, В. А. Мокрицький, Ю. О. Гунченко [та ін.] // Современ. информ. и электрон. технологии (СИЭТ–2010): тр. XI междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 24–28 мая 2010 г. / М-во пром. политики Украины, МОН Украины, Одес. нац. политехн. ун-т. – Одесса, 2010. – Т. 2. – С. 110.
207. Про механізм електролюмінісценції тонкоплівкових структур для пристроїв відображення інформації / В. А. Мокрицький, А. І. Казаков, О. В. Андріянов, О. В. Селюков // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 32–35.
208. Радиационная модификация спектров фотолюминесценции арсенида галлия / Я. И. Лепих, В. А. Мокрицкий, С. В. Ленков, О. В. Банзак, Ю. А. Гунченко // Сенсорна електроніка і мікросистемні технології. – 2010. – № 1 (7). – С. 11–12.
209. Радиационное изменение структуры кристаллов полупроводниковых соединений / С. В. Ленков, В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, Ю. А. Гунченко // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2010. – Вип. 28. – С. 79–83.

2011

210. Аналіз механізмів відпалу лазерних кристалів CdS / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, О. С. Гаркавенко [та ін.] // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту КНУ ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. № 33. – С. 96–98.

211. Вплив дефектів структури на вольт-амперні та люмінісцентні характеристики приладів / В. А. Мокрицький, С. В. Ленков, О. В. Банзак, Ю. О. Гунченко // Соврем. информ. и электрон. технологии : тр. XII Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 23–27 мая 2011 г. – Одесса, 2011. – С. 288.

212. Выявление последствий размытия цифрового изображения / В. А. Мокрицкий, В. В. Зорило // Информатика и мат. методы в моделировании. – 2011. – Т. 1, № 3. – С. 220–227.

213. Массоперенос при жидкофазной эпитаксии двухслойных систем / С. Н. Дранчук, В. А. Завадский, В. А. Мокрицкий // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2012. – № 5. – С. 48–51. – Библиогр. : 5 назв.

214. *Модифікація твердотільної матричної основи квантоворозмірними включеннями / В. А. Мокрицький, В. В. Ковальчук, О. В. Андріянов, В. О. Рац // Вісн. інженер. акад. України. – 2011. – № 2.

215. Модуляційні властивості кристала CdSy видимій області спектра при електронному накачуванні / О. С. Гаркавенко, В. А. Мокрицький, О. В. Банзак, Ю. О. Гунченко // Соврем. информ. и электрон. технологии : тр. XII Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 23–27 мая 2011 г. – Одесса, 2011. – С. 289.

216. Стійкий до завад стегано-графічний алгоритм, який використовує просторову область контейнера при стегоперетворенні / В. А. Мокрицький, І. І. Борисенко // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2011. – Вип. 33. – С. 187–191.

217. Технично-економическіе задачі ефективного контролю безпеки АЭС / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов // Экономист. – 2011. – № 8. – С. 70–74.

2012

218. *Использование монокристаллов CaZnTe для увеличения эффективности датчиков гамма-излучения / В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, О. В. Маслов // Соврем. информ. и электрон. технологии : тр. XIII Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса, 2012.

219. *Исследование возможности увеличения эффективности датчиков гамма-излучения / В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, О. В. Маслов // Современ. информ. и электрон. технологии : тр. XIII Междунар. науч.-практ. конф. – Одесса, 2012.

220. Коррекция зависимости чувствительности Cd ZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2012. – Вип. 39. – С. 81–84.

221. Массоперенос при жидкофазной эпитаксии двухслойных систем / С. Н. Дранчук, В. А. Завадский, В. А. Мокрицкий // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2012. – № 5. – С. 48–51. – Библиогр. : 5 назв.

222. Оценка влияния частоты дискретизации на погрешность измерения мощности дозы блоком детектирования на основе CdZnTe / О. В. Банзак, О. В. Маслов, В. А. Мокрицкий // Електромагніт. та акуст. методи неруйн. контролю матеріалів та виробів : матеріали 17 Міжнар. наук.-техн. конф. (Леотест–2012). – 2012. – № 17 – С. 15.

223. Радиационная модификация физических свойств широкозонных полупроводников и создание на их основе лазеров большой мощности : монография / А. С. Гаркавенко ; под ред. В. А. Мокрицкого. – Л. : ЗУКЦ, 2012. – 257 с. – (Соврем. квантовые и корпускуляр. технологии). – Библиогр.: с. 212–237.

224. *Термополевой метод контроля качества кристаллов кадмий-цинк-теллур / О. В. Банзак, О. В. Маслов, В. А. Мокрицкий // Неразрушающий контроль : 17-ая Междунар. науч.-техн. конф. – Славское, Львов. обл., 2012.

2013

225. *Блок детектирования гамма-излучения на основе CdZnTe для систем радиационно-технологического контроля / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак, В. А. Завадский // Датчики, приборы и системы – приборостроение : междунар. науч.-техн. конф. – Ялта, 2013.

226. *Воздействие ионизирующих излучений на параметры полупроводниковых оптических элементов / В. А. Мокрицкий, А. В. Селюков, О. В. Банзак // Датчики, приборы и системы : междунар. науч.-техн. конф. – Ялта, 2013.

227. *Датчики нового поколения для контроля и дозиметрии ионизирующих излучений / О. В. Банзак, В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов // Методи та засоби

неруйн. контролю пром. обладнання : тези доп. 4-ої наук.-практ. конф. студентів і молодих вчених. – Івано-Франківськ, 2013.

228. Коррекция зависимости чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 39. – С. 81–84.

229. Метод жидкофазной эпитаксии толстых слоев / С. Н. Дранчук, В. А. Завадский, В. А. Мокрицкий // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2013. – № 2–3. – С. 58–60. – Библиогр. : 6 назв.

230. Методы определения выгорания на основе измерений характеристик собственного излучения отработанного ядерного топлива / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2013. – Вип. 43. – С. 86–92.

231. Полупроводниковые детекторы нового поколения для радиационного контроля и дозиметрии ионизирующих излучений / О. В. Банзак, В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов. – Одесса : ВМВ, 2013. – 220 с. – (Соврем. технологии электроники). – Библиогр.: 153 назв.

232. Получение кремния электродным восстановлением продуктов пиролиза рисовой лузги / А. В. Мокрицкий, И. Е. Марончук, Б. П. Масенко, М. В. Повстяной, В. А. Завадский, О. В. Соловьев // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2003. – № 1. – С. 42–43. – Библиогр.: 5 назв.

233. Теория и практика жидкофазной эпитаксии и радиационной технологии полупроводников : монография / В. А. Мокрицкий, С. Н. Дранчук, В. А. Завадский, Е. М. Курицын, В. С. Шобик. – Одесса : Астропринт, 2013. – 319 с. – (Соврем. технологии электроники). – Библиогр.: 178 назв.

2014

234. Автоматизированная система определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2014. – № 5/6. – С. 63–71. – Библиогр.: 15 назв.

235. Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистемах / І. З. Якименко, Л. М. Тимошенко,

В. А. Мокрицький // Інформатика та мат. методи в моделюванні. – Том 4, № 2. – 2014. – С. 165–172.

236. Влияние радиационного облучения на параметры полупроводниковых фотоэлектронных приборов / В. А. Завадский, В. А. Мокрицкий // Современ. информ. и электрон. технологии : тр. XV Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 26–30 мая 2014 г. – Одесса, 2014. – Т. 2. – С. 111–112. – Библиогр.: 6 назв.

237. Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Ч. 1. Теоретические предпосылки / А. С. Гаркавенко, В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, В. А. Завадский // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2014. – № 4. – С. 50–55. – Библиогр.: 14 назв.

238. Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Часть 2 : Эксперимент / А. С. Гаркавенко, В. А. Мокрицкий, О. В. Банзак, В. А. Завадский // Технология и конструирование в электрон. аппаратуре. – 2014. – № 5/6. – С. 51–56. – Библиогр.: 17 назв.

239. Методика определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 45. – С. 79–83.

240. Системы индивидуального дозиметрического контроля / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Современ. информ. и электрон. технологии : тр. XV Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 26–30 мая 2014 г. – Одесса, 2014. – Т. 2. – С. 78–79. – Библиогр.: 4 назв.

241. Сравнительный анализ известных алгоритмов компьютерной томографии ядерного топлива тепловыделяющих сборок / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2014. – Вип. 46. – С. 102–107.

2015

242. Комплекс индивидуального дозиметрического контроля / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Современ. информ. и электрон. технологии : тез. докл. Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 25–29 мая 2015 г. – Одесса, 2015. – С. 198–199.

2016

243. К механизму массопереноса при жидкофазной эпитаксии полупроводников / В. А. Завадский, С. Н. Дранчук, В. А. Мокрицкий // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2016. – Вип. 51. – С. 42–48.

244. Моделирование аппаратных спектров CdZnTe-детектора / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов // Современ. информ. и электрон. технологии (СИЭТ–2016) : тр. XVII Междунар. науч.-практ. конф., г. Одесса, 23–27 мая 2016 г. – Одесса, 2016. – С. 206–207.

245. Принципи дії, характеристики та параметри елементної бази мікро- та наноелектроніки : навч. посіб. / О. В. Андріянов, В. А. Мокрицький. – Одеса : Наука і техніка, 2016. – 56 с. – Бібліогр.: 4 назви.

2017

246. Усовершенствование стеганографического алгоритма, основанного на SIGN-нечувствительности сингулярных векторов блоков матрицы изображения / А. А. Кобозева, В. А. Мокрицкий, Л. Е. М. Батиене, И. И. Бобок // Информатика та мат. методи в моделюванні. – 2017. – Т. 7, № 1–2. – С. 19–28. – Библиогр.: 16 назв.

247. The block of detecting scale-radiation on the basis of CdZnTe-gauge for systems of the radiating technological control / V. A. Mokritskij, O.V. Maslov, O. V. Banzak // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 68–73.

248. The detector on basis of CdZnTe-gauge for systems radiating-technological control / V. A. Mokritskij, O.V. Maslov, O. V. Banzak // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2017. – Вип. 57. – С. 89–95.

2018

249. Анализ влияния ионизирующих излучений на фотоприемные приборы / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018 – № 62. – С. 50–56.

250. Аналитическая модель влияния ионизирующего излучения на фоторезисторы для ИК-диапазона / О. В. Банзак, О. И. Лещенко, В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов // Зб. наук. пр. Війс. ін-ту Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – Київ, 2018 – № 62. – С. 10–16.

251. Комп'ютерний імітатор для дослідження характеристик елементів напівпровідникової електроніки / В. А. Мокрицький, К. О. Головченко // Сучас. информ. та електрон. технології : пр. XIX Міжнар. наук.-практ. конф.,

м. Одеса, 28 трав.–1 черв. 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 16–17. – Бібліогр.: 3 назви.

252. Система для выявления скрытых органических взрывчатых веществ ядерно-физическими методами / В. А. Мокрицкий, О. В. Маслов, О. В. Банзак // Сучас. інформ. та електрон. технології : пр. XIX Міжнар. наук.-практ. конф., м. Одеса, 28 трав.–1 черв. 2018 р. – Одеса, 2018. – С. 85–86. – Бібліогр.: 3 назв.

253. Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Мокрицького. – 2-ге вид., випр., перероб., доп. – Одеса : Екологія, 2018. – Т. 1 : Фіз. основи мікроелектроніки / В. А. Мокрицький, О. В. Маслов. – Одеса, 2018. – 204 с.

254. Фізико-технічні основи мікроелектроніки : монографія : у 2 т. / за заг. ред. В. А. Мокрицького. – 2-ге вид., випр., перероб., доп. – Одеса : Екологія, 2018. – Т. 2 : Матеріалознавство, конструктор.-технол. основи мікроелектроніки / В. А. Мокрицький, С. М. Дранчук, О. В. Андріянов. – Одеса : Екологія, 2018. – 264 с.

255. Multiple Energies Passive Computer Tomography of Nuclear Fuel / O. V. Maslov, V. A. Mokritskiy, A. V. Sokolov // International Journal of Tomography & Simulation. – 2018. – Vol. 31. – N 1. – P. 1–13.

2019

256. Квантова електроніка : навч. посіб. / В. А. Мокрицький. – Одеса : Екологія, 2019. – 317 с. – Бібліогр.: 11 назв.

257. Математика. Євроминимум для студентів и школьників : учебник / О. М. Михлин, А. С. Гаркавенко, В. А. Мокрицький ; под ред. В. А. Мокрицького. – Одеса : Екологія, 2019. – 268 с.
с.

ПОКАЖЧИК ЗВІТІВ НДР

1969

258. Исследование возможностей получения автоэпитаксиальных слоев /АЭС/ легированного и нелегированного арсенида галлия из раствора-расплава для создания на их основе генераторов Ганна и р-п переходов. Экономическая эффективность производства арсенида галлия из раствора-расплава : отчет о НИР (рукопись) / Одес. политехн. ин-т, каф. теорет. физики инженер.-физ. ф-та ; рук. темы В. Кузнецов ; отв. исполн. : В. Мокрицкий, Б. Полонский. – Одесса, 1969. – 25 с. – Библиогр.: 6 назв.

259. Исследование возможностей получения пленок арсенида галлия методом жидкостной эпитаксии : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. теорет. физики инженер.-физ. ф-та ; рук. темы В. И. Кузнецов ; отв. исполн. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1969. – 187 с. : ил. – № ГР 68047866.

1973

260. Разработка методики контроля неоднородности высокоомных фоточувствительных полупроводниковых материалов методом темного зонда для целей микроэлектроники : отчет НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводников ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. Н. Рыбин. – Одесса, 1973. – 68 с. – Б298614.

261. Разработка технологии автоэпитаксии германия из раствора в расплавах металлов : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводниковых материалов ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. А. И. Казаков. – Одесса, 1973. – 133 с. : ил. – Библиогр.: 165 назв. – № ГР 72019139.

1974

262. Исследование неоднородностей высокоомного кремния и характеристик системы кремний-диэлектрик. Раздел 1-2-3-4 : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводников ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. : Ю. Сухарев [и др.]. – Одесса, 1974. – 180 с. – Б 389880.

263. Исследование технологии изготовления и конструкции транзисторов типа МП-25, МП-26 с целью устранения включений индия в перефирийные области рекристаллизованных слоев Р-П переходов : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводниковых материалов ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. А. И. Казаков. – Одесса, 1974. – 45 с. – Б314335.

1975

264. Исследование и разработка технологии получения слоев арсенида и фосфида галлия на одноименные и инородные подложки методом эпитаксии из раствора-расплава : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводниковых материалов ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1975. – 114 с. – № ГР 71031473.

265. Исследование свойств полупроводниковых пленок (слоев) и процессов эпитаксии для целей микроэлектроники : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводниковых материалов ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. Ю. Г. Сухарев. – Одесса, 1975. – 121 с. – № Б 477625.

266. Оптимизация параметров диффузионных слоев планарных систем на основе эпитаксиальных пленок кремния. Разд. 1-4 : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводниковых материалов ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. Н. Рыбин. – Одесса, 1975. – 112 с. – Инв. № Б 466630.

1976

267. Исследование свойств и радиационная обработка многослойных структур для совершенствования технологии производства высоковольтных транзисторов : в 2 т. : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. Н. Рыбин. – Одесса : [б. и.], 1976. – Б 573550.

Т. 1. – 63 с.

Т. 2. – 121 с.

1977

268. Исследование процессов ионно-плазменной обработки кремния при изготовлении полупроводниковых приборов : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводников ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. Ю. Г. Сухарев, А. А. Гребенников. – Одесса : [б. и.], 1977. – 49 с. – Библиогр.: 35 назв. – ГР 76068982. – Инв. № Б678767.

1978

269. Исследование и разработка технологии получения слоев Арсенида и Фосфида Галлия на одноименные подложки методом эпитаксии из раствора-расплава : отчет НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводников ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1978. – 92 с. – Библиогр.: 63 назв. – Шифр темы 612-26. – ГР 71031473. – Инв. №Б755633.

270. Исследование процессов получения и разработка методов контроля свойств многослойных полупроводниковых и диэлектрических систем : отчет НИР / Одес. политехн. ин-т, каф. полупроводников ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. Н. Рыбин. – Одесса, 1978. – 107 с. – Библиогр.: 113 назв. – ГР 78055332. – Инв. № Б755635.

1980

271. Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций. Легирование азотом : промежуточный отчет / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1980. – 35 с.

272. Исследование электрофизических и структурных свойств многослойных полупроводниковых систем и процессов их получения для целей микроэлектроники : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса : [б. и.], 1980. – 64 с. – ГР 76048652. – Инв. № Б967825.

1981

273. Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокации / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1981. – 115 с. – Библиогр.: 89 назв. – Шифр темы 537-34. – ГР 79029317. – Инв. №0282.1 044186.

274. Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1981. – 134 с. – Библиогр.: 89 назв. – № ГР 79029317.

275. Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций. Этап 1. Патентный поиск по способам получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. : В. А. Завадский, С. Н. Дранчук. – Одесса, 1981. – 60 с.

276. Исследование процесса получения стойких полупроводниковых материалов эпитаксией из жидкой фазы : отчет по НИР / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. Е. М. Курицын. – Одесса, 1981. – 118 с. – Библиогр.: 47 назв. – ГР 79020147. – Инв. №0282.8020338.

1982

277. Исследование взаимосвязи параметров преобразователей изображений со свойствами и технологией получения арсенида и фосфида галлия. Этап 2. Анализ влияния основных технологических факторов на структурные свойства слоев арсенида и фосфида галлия : техническая информация / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1982. – 4 с.

1983

278. Исследование взаимосвязи параметров преобразователей изображений со свойствами и технологией получения арсенида и фосфида галлия : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1983. – 37 с. – Библиогр.: 27 назв. – № ГР 01825017588. – Инв. № 0284.0029306.

1984

279. Исследование свойств арсенида галлия для изготовления прозрачных в ИК-диапазоне окон : этапы Т1а, Т1б, Т1в : техническая информация / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1984. – 20 с.

1985

280. Исследование процессов получения многослойных систем на основе полупроводниковых материалов для целей микроэлектроники : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. С. Н. Дранчук. – Одесса, 1985. – 86 с. – Библиогр.: 43 назв. – ГР 81087290. – Инв. №0286.0028439

281. Исследование свойств арсенида галлия для изготовления прозрачных в ИК-диапазоне окон : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1985. – 52 с. – Библиогр.: 39 назв. – № ГР 01840078899. – Инв. № 0286.0002014.

282. Разработка процессов получения и исследования свойств элементарных полупроводников и многокомпонентных соединений для повышения стойкости создаваемых на их основе приборов : ч. 1–2 : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. Е. М. Курицын. – Одесса, 1985. – 88 с. – Номер темы 753-26. – ГР 01821009177. – Инв. №0286.0025667.

283. Разработка технологических процессов получения волноводных элементов среднего ИК диапазона и изготовление опытных образцов волноводов и фотодетекторов на их основе. Ч. 1–2 : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. Ю. А. Запорожченко. – Одесса, 1985. – 179 с. – ГР 01830066540. – Инв. №0286.0 015036.

1986

284. Провести литературный обзор по методам получения слоев. Исследовать структурные свойства исходных подложек. Разработать методику эпитаксии слоев : техническая информация : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т ; рук. темы В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. С. Н. Дранчук. – Одесса, 1986. – 65 с. : ил. – Библиогр.: 59 назв.

285. Разработка способов повышенной надежности получения многокомпонентных соединений для изготовления фотоприемников ИК-излучения среднего диапазона. Делитель. Этап Т1а «Исследовать процесс деградации материала активного элемента фотоприемника» : техническая информ. : промежуточный отчет / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. В. А. Завадский. – Одесса, 1986. – 8 с.

1987

286. «Терек-1» : отчет о НИР (заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. С. Н. Дранчук. – Одесса, 1987. – 127 с. – Библиогр.: 79 назв.

287. «Терек-1». Подготовить партию слоев в условиях заказчика. Рассчитать диаграммы состояния систем на основе соединений типа А2В6. Техническая информация : отчет о НИР / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; отв. исполн. С. Н. Дранчук. – Одесса, 1987. – 42 с. : ил. – Библиогр.: 12 назв.

288. Исследование процессов получения и свойств многослойных систем на основе многокомпонентных материалов для опто- и микроэлектроники : отчет о НИР (Заключительный) / Одес. политехн. ин-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий. – Одесса, 1991. – 164 с. – Тема 18-74. – ГР 01870016276. – Инв. № 02.9.10050321.

2003

289. Изготовление и повышение надежности ик-фотоприемников на основе многокомпонентных соединений : отчет о НИР (заключительный) / Одес.

нац. политехн. ун-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий. – Тема №415-74. – ГР 0101U001254. – Инв. №0204U000987. – Одесса, 2003. – 88 с.

2005

290. Датчик гамма-излучений на основе кадмий-цинк-теллур (КЦТ) (шифр 4-13) (заключительный) : отчет о НИР / Одес. нац. политехн. ун-т ; науч. рук. В. А. Мокрицкий. – Тема 449-74; ГР 0104U002402; Инв. № 0206U004539. – Одесса, 2005. – 72 с.

АВТОРСЬКІ СВДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ

291. А. с. 736219 СССР, МПК Н 01 L 21/263. Способ обработки эпитаксиальных слоев кремния / Е. М. Курицын, В. А. Мокрицкий, В. И. Шаховцов (СССР). – № 2598651/18-25 ; заявл. 07.04.78 ; опубл. 25.05.80, Бюл. № 19.

292. А. с. 1366889 СССР, МКИ⁴ G 01 R 19/02. Устройство для измерения действующего значения напряжения в диапазоне инфразвуковых частот / В. А. Мокрицкий (СССР). – № 4020690/24-21 ; заявл. 12.03.86 ; опубл. 15.01.88, Бюл. № 2.

ДИСЕРТАЦІЇ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ

В.А. МОКРИЦЬКОГО

Банзак О. В. Методы и средства радиационной модификации свойств полупроводниковых материалов и приборов : дис. ... канд. техн. наук : спец. 05.27.01 – Твердотельная электроника / О. В. Банзак ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; Одес. нац. политехн. ун-т. – Одесса, 2009. – 184 с. : рис., табл. – Библиогр.: 95 назв.

Завадский В. А. Исследование процесса эпитаксии слоев фосфида галлия в системах Ga-GaP и Si-Sn-GaP и применение их в полупроводниковых приборах : дис. ... канд. техн. наук / В. А. Завадский ; науч. рук. : В. И. Кузнецов, В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1973. – 175 с. : рис. – Библиогр.: 290 назв.

Казаков А. И. Исследование эпитаксии веществ из раствора в расплавах металлов на примере германия для производства полупроводниковых приборов : дис. ... канд. техн. наук : / А. И. Казаков ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1972. – 137 с.

Курицын Е. М. Влияние радиации на электрофизические свойства и процессы роста слоев полупроводников : дис. ... канд. техн. наук / Е. М. Курицын ; науч. рук. В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т, Ин-т физики АН УССР. – Одесса ; Киев, 1983. – 221 с. : рис. – Библиогр.: 129 назв.

Литвин А. А. Исследование роста и разработка высокопроизводительного процесса получения эпитаксиальных структур фосфида галлия для оптоэлектроники : дис. ... канд. техн. наук / А. А. Литвин ; науч. рук. : В. А. Мокрицкий, Ю. Г. Пухов ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1975. – 218 с. : рис. – Библиогр.: 165 назв.

Муратов А. Ф. Исследование электрофизических и структурных характеристик высокочистого монокристаллического кремния, применяемого для изготовления детекторов ядерных излучений : дис. ... канд. техн. наук / А. Ф. Муратов ; науч. рук. : В. А. Преснов, В. А. Мокрицкий ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1973. – 124 с. : рис., табл. – Библиогр.: 119 назв.

Орел В. И. Исследование и разработка технологии эпитаксии слоев твердых растворов $Al_x Ga_{1-x} As$ для оптоэлектроники : дис. ... канд. техн. наук / В. И. Орел ; науч. рук. : В. А. Мокрицкий, И. Е. Марончук ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1974. – 121 с. : рис. – Библиогр.: 112 назв.

Турчанинов Ю. Н. Исследование свойств и разработка технологии эпитаксии слоев кремния для производства полупроводниковых приборов : дис. ... канд. техн. наук / Ю. Н. Турчанинов ; науч. рук. В. А. Мокрицкий, И. Н. Магден ; Одес. политехн. ин-т. – Одесса, 1975. – 190 с. : рис. – Библиогр.: 175 назв.

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ

А

- Автоматизированная система определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива 234
- Алмазоподобные пленки в микроэлектронике 112
- Анализ влияния ионизирующих излучений на фотоприемные приборы 249
- Анализ диффузионных процессов при жидкофазной эпитаксии 83
- Анализ кинетики эпитаксии твердых растворов 88
- Аналіз механізмів відпалу лазерних кристалів CdS 210
- Анализ термодинамической устойчивости твердых растворов в системе КРТ 65
- Аналитическая модель влияния ионизирующего излучения на фоторезисторы для ИК-диапазона 250

Б

- Багатоелементні лазери на основі сполук A_2B_6 , A_3B_5 169
- Безконтактна багатокомпозиційна інформаційно-вимірювальна система 113
- Блок детектирования гамма-излучения на основе CdZnTe для систем радиационного контроля 152
- Блок детектирования гамма-излучения на основе CdZnTe для систем радиационно-технологического контроля 225

В

- Використання символів Якобі для генерування параметрів еліптичної кривої в криптосистем 235
- Властивості оптичних вікон для сенсорів ІЧ-діапазону 170
- Влияние быстрых электронов на свойства эпитаксиальных слоев кремния и параметры фоторезисторов на их основе 176
- Влияние гамма-облучения на основные параметры фоторезисторов на основе Cd-Hg-Te 199
- Влияние ионизирующих излучений на параметры и свойства оптических полупроводниковых и температурно-преобразовательных элементов 127
- Влияние кристаллографической ориентации на рост и свойства слоев $Al_xGa_{1-x}As$ 28
- Влияние легирования на структурное совершенство эпитаксиальных слоев фосфида галлия 46
- Влияние облучения быстрыми нейтронами на эпитаксиальный арсенид галлия 128

- Влияние облучения и термоциклирования на параметры и свойства оптических полупроводниковых элементов 140
- Влияние облучения на диффузию бора в эпитаксиальные слои кремния 40
- Влияние пересыщения кристаллизационной среды на структурное совершенство эпитаксиальных слоев 47
- Влияние пересыщения раствора на структурное совершенство эпитаксиальных слоев 79
- Влияние радиации на растворимость полупроводников 52
- Влияние радиационного облучения на параметры полупроводниковых фотоэлектронных приборов 236
- Влияние радиационного облучения на свойства высокотемпературной керамики (ВТСП) 92
- Влияние радиационного облучения на характеристики солнечных элементов из поликристаллического кремния 114
- Влияние радиационной обработки на параметры интегральных преобразователей температуры 115
- Влияние состава молекулярного пучка на свойства тонких пленок 16
- Влияние ультразвуковых колебаний на процесс эпитаксии слоев 10
- Воздействие акустических пристеночных течений на процесс очистки полупроводниковых подложек 57
- Воздействие ионизирующих излучений на параметры полупроводниковых оптических элементов 177
- Воздействие ионизирующих излучений на материалы электронной техники 93
- Воздействие ионизирующих излучений на параметры полупроводниковых оптических элементов 226
- Воздействие малых доз радиационного излучения на свойства керамики Y-Ba-Cu-O (1-2-3) 96
- Возможности гетероэпитаксии в системе Sn-Ge-G₂AS 31
- Возникновение помех в измерительных цепях авиационной РЭА и способы борьбы с ними 129
- Вплив дефектів структури на вольт-амперні та люмінісцентні характеристики приладів 211
- Вплив дефектів функціональних матеріалів на надійність електроніки 141
- Вплив дефектів функціональних матеріалів на надійність електроніки 142
- Вплив інтенсивних пучків електронів на характеристики напівпровідникових лазерів 171
- Вплив іонізуючих випромінювань на епітаксійні шари фосфіду галія 188
- Вплив малих доз опромінювання швидкими нейтронами та електронами на температурну залежність опору кераміки YBa₂Cu₃O_{7-x} 100
- Выявление последствий размытия цифрового изображения 212

Г

- Гетеропереходы фосфид галлия-кремний в приемниках ИК-излучения 26
- Гетероэпитаксия слоев полупроводниковых веществ из многокомпонентных растворов 30
- Гетероэпитаксия слоев соединений АЗВ5 из жидкой фазы 53
- Гетероэпитаксия слоев соединений из жидкой фазы на подложках из элементарных полупроводников 48
- Гетероэпитаксия слоев соединений из жидкой фазы на подложках из элементарных полупроводников 84
- Гетероэпитаксия слоев соединений из жидкой фазы на подложках элементарных полупроводников 32

Д

- Датчик гамма-излучений на основе кадмий-цинк-теллур (КЦТ) (шифр 4-13) (заключительный) 290
- Датчики гамма-излучения на основе соединения кадмий-цинк-теллур (КЦТ) 145
- Датчики нового поколения для контроля и дозиметрии ионизирующих излучений 227
- Деградація лазерів на основі багатоконпонентних напівпровідникових сполук 172
- До механізму виникнення дефектів структури напівпровідників 146
- Дослідження властивостей шарів фосфіду галія після імплантації домішок 178
- Дослідження впливу конструктивних дефектів на властивості кремнієвих фотоелектричних перетворювачів 153
- Дослідження радіаційної модифікації первинних перетворювачів температури 189
- Дослідження термопружного механізму впливу високоенергетичного електронного пучка на досконалість напівпровідникових кристалів 157

Е

- Електролюмінесценція багатоконпонентних матеріалів 158
- Епітаксія матеріалів оптоелектроніки 147

Ж

- Жидкофазная эпитаксия слоев арсенида галлия в радиационном поле 54

3

Закономерности управления структурными свойствами слоев при жидкофазной эпитаксии 55

Залежність діелектричної проникливості композитів для авіаційної техніки від параметрів їх компонентів 116

Засоби підвищення ефективності оптоелектронних МДН приладів 200

Знешкодження джерел іонного забруднення, як один з шляхів забезпечення стабільності напівпровідникових приладів 117

И

Измерение вида вольтамперной характеристики тиристоров при отрицательном смещении в цепи управления 2

Измерение температуры по фазовому сдвигу лазерного излучения 90

Инструкция к лабораторным работам по курсу "Технология радиоаппаратостроения" для специальности 0705 "Конструирование и производство радиоэлектронной аппаратуры 20, 21

Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Ч. 1. Теоретические предпосылки 237

Ионизационный отжиг полупроводниковых кристаллов. Часть вторая : эксперимент 238

Использование биений для повышения точности измерения действующего значения напряжения в диапазоне инфразвуковых частот методом сравнения 62

Использование монокристаллов CaZnTe для увеличения эффективности датчиков гамма-излучения 218

Исследование взаимосвязи параметров преобразователей изображений со свойствами и технологией получения арсенида и фосфида галлия. Этап 2. Анализ влияния основных технологических факторов на структурные свойства слоев арсенида и фосфида галлия 277

Исследование взаимосвязи параметров преобразователей изображений со свойствами и технологией получения арсенида и фосфида галлия 278

Исследование возможностей получения автоэпитаксиальных слоев /АЭС/ легированного и нелегированного арсенида галлия из раствора-расплава для создания на их основе генераторов Ганна и р-п переходов. Экономическая эффективность производства арсенида галлия из раствора-расплава 258

Исследование возможностей получения пленок арсенида галлия методом жидкостной эпитаксии 259

Исследование возможности увеличения эффективности датчиков гамма-излучения 219

Исследование деформации торцевой поверхности болта методом оптической голографической интерферометрии 190

Исследование и разработка технологии получения слоев арсенида и фосфида галлия на одноименные и инородные подложки методом эпитаксии из раствора-расплава 264

Исследование и разработка технологии получения слоев Арсенида и Фосфида Галлия на одноименные подложки методом эпитаксии из раствора-расплава 269

Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций. Легирование азотом : промежуточный отчет 271

Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокации 273

Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций 274

Исследование и разработка технологии получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций. Этап 1. Патентный поиск по способам получения эпитаксиальных слоев фосфида галлия с пониженной плотностью дислокаций 275

Исследование массопереноса в жидкой фазе при эпитаксии слоев полупроводников путем принудительного охлаждения раствора-расплава 58

Исследование начальных стадий кристаллизации ав-гоэпитаксиальных слоев арсенида галлия 3

Исследование неоднородностей высокоомного кремния и характеристик системы кремний-диэлектрик 262

Исследование по теории процессов управления свойствами кристаллов и слоев 74

Исследование приемников ИК-излучения на основе гетероэпитаксиальной системы кремний-фосфид галлия 27

Исследование процесса зарождения пленок арсенида галлия при ориентированном наращивании из раствора 4

Исследование процесса получения стойких полупроводниковых материалов эпитаксией из жидкой фазы 276

Исследование процесса эпитаксии слоев арсенида галлия из раствора-расплава, технология их получения и возможности использования в полупроводниковых приборах 8

Исследование процесса эпитаксии слоев полупроводниковых материалов в поле гамма-излучения 49

Исследование процессов ионно-плазменной обработки кремния при изготовлении полупроводниковых приборов 268

Исследование процессов получения и разработка методов контроля свойств многослойных полупроводниковых и диэлектрических систем 270

Исследование процессов получения и свойств многослойных систем на основе многокомпонентных материалов для опто- и микроэлектроники 288

Исследование процессов получения и свойств многослойных систем на основе многокомпонентных материалов для опто- и микроэлектроники 289

Исследование процессов получения многослойных систем на основе полупроводниковых материалов для целей микроэлектроники 280

Исследование радиационной стойкости гибридных интегральных микросхем 179

Исследование радиационной стойкости гибридных интегральных микросхем 180

Исследование свойств арсенида галлия для изготовления прозрачных в ИК-диапазоне окон : этапы ТIа, ТIб, ТIв 63

Исследование свойств арсенида галлия для изготовления прозрачных в ИК-диапазоне окон : этапы ТIа, ТIб, ТIв 279

Исследование свойств арсенида галлия для изготовления прозрачных в ИК-диапазоне окон 281

Исследование свойств и радиационная обработка многослойных структур для совершенствования технологии производства высоковольтных транзисторов 267

Исследование свойств перехода в системе подложка-эпитаксиальный слой 11

Исследование свойств полупроводниковых пленок (слоев) и процессов эпитаксии для целей микроэлектроники 265

Исследование технологии изготовления и конструкции транзисторов типа МП-25, МП-26 с целью устранения включений индия в перефирийные области рекристаллизованных слоев Р-П переходов 263

Исследование условий эпитаксии арсенида галлия 9, 12

Исследование физико-химических процессов жидкофазной эпитаксии и разработка способов управления свойствами слоев на примере элементарных полупроводников и соединений типа АЗВ5 56

Исследование электрофизических и структурных свойств многослойных полупроводниковых систем и процессов их получения для целей микроэлектроники 272

Исследования концентрационных зависимостей тонкопленочных электролюминесцентных структур на основе ZnS HoF3 101

К

К механизму массопереноса при жидкофазной эпитаксии полупроводников 243

К феноменологической теории жидкофазной эпитаксии 13

Квантова електроніка 256

Кинетика роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных растворов из жидкой фазы 71

Кинетика роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов из жидкой фазы 59

Класифікація і порівняльна оцінка індикаторів для пристроїв відображення інформації 191

Комп'ютерний імітатор для дослідження характеристик елементів напівпровідникової електроніки 251

Комплекс индивидуального дозиметрического контроля 242

Коррекция зависимости чувствительности Cd ZnTe-детектора от энергии гамма-излучения 220

Коррекция зависимости чувствительности CdZnTe-детектора от энергии гамма-излучения 228

Л

Лазеры в метрології напівпровідників 159

Лазерные диоды на основе твердого раствора индий-галлий-мышьяк-фосфор 201

М

Массоперенос при жидкофазной эпитаксии двухслойных систем 213

Массоперенос при жидкофазной эпитаксии двухслойных систем 221

Математика. Евроминимум для студентов и школьников 257

Математична модель системи математичного регулювання перетворювачем електроенергії 202

Материалы и условия эксплуатации датчиков ИК-излучений 148

Метод жидкофазной эпитаксии толстых слоев 229

Метод керування характеристиками акустооптичних пристроїв 192

Метод керування характеристиками акустооптичних пристроїв 203

Методи покращення ефективності напівпровідникових фотоприймачів ІЧ-випромінювання 181

Методика и средства контроля технического состояния цифровых приборов, содержащих элементы с обратными связями 154

Методика определения глубины выгорания отработавшего ядерного топлива (ОЯТ) 239

Методика отримання і електричні властивості алмазоподібних плівок 160

Методика оценки эффективности применения индикаторов различных типов в бортовых средствах отображения информации 103

Методические указания к лабораторным работам по курсу микроэлектроника и микросхемотехника для студентов специальности 0612 66

Методические указания к лабораторным работам по курсу микроэлектроника и микросхемотехника для студентов специальности 20.05 85

Методические указания к практическим занятиям по курсу "Физические основы электронной техники" для студентов специальности 0612 67

Методические указания к решению задач по дисциплине "Физические основы электронной техники" для студентов специальности 0612 72

Методические указания, программа и контрольные работы по курсу "Микроэлектроника и микросхемотехника". Раздел "Микроэлектроника" для студентов специальности 20.05 89

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни "Матеріали електронної техніки та технологічні основи електроніки" для студентів спеціальності 7.090805 108

Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисципліни «Конструювання і виробництво пристроїв автоматики» для студентів фаху 7.091401 107

Методы определения выгорания на основе измерений характеристик собственного излучения отработанного ядерного топлива 230

Методы улучшения характеристик тонкопленочных электролюминесцентных структур 104

Механизмы массопереноса вещества при жидкофазной эпитаксии слоев 75

Микроэлектронные датчики температуры в измерительных системах 118

Моделирование аппаратных спектров CdZnTe-детектора 244

Моделирование воздействия нейтронного облучения на структуру кристаллической решетки керамики Y-Ba-Cu-O 98

Моделирование критических явлений в функциональных материалах микроэлектроники с использованием теории катастроф 193

Моделирование процессов жидкофазной эпитаксии Для служебного пользования 73

Моделирование процессов роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов из переохлажденного раствора-расплава 80

Моделирование процессов роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов из переохлажденного раствора-расплава 86

Моделирование стабильности многокомпонентных неомогенных полупроводниковых материалов с использованием теории катастроф 204

Моделирование термодинамической стабильности полупроводниковых твердых растворов с неоднородным распределением состава 182

Модель деградації ІЧ фотоприймачів 161

Модификация свойств полупроводникового соединения CdS при облучении ионами неона 205

Модифікація твердотільної матричної основи квантоворозмірними включеннями 214

Модифицированный фосфид галлия для лазеров и мощных светодиодов 119

Модуляційні властивості кристала CdSy видимій області спектра при електронному накачуванні 215

Мощные резисторы нового поколения на основе углеродных (алмазоподобных) пленок 162

Н

- Напівпровідникові лазери з електронним накачуванням 163, 164
Напівпровідникові та акустоелектронні оптичні сенсори і системи 194
Новые лазерные методы, средства и технологии 130

О

- О возникновении структур взаимных границ между кристаллами 17
Обработка монокристаллов CdZnFe для применения в датчиках гамма-излучения 120
Определение разориентированности монокристаллических подложек и наращиваемых на них слоев на ранней стадии эпитаксии 22
Оптимизация параметров диффузионных слоев планарных систем на основе эпитаксиальных пленок кремния 266
Оптимізація умов експлуатації напівпровідникових лазерів з електронною накачкою енергії 206
Оптоэлектроника инфракрасного диапазона : материалы, прилады, системы 155
Основи проектування інтегральних схем 195
Особенности импульсного управления и работы при обратном смещении цепи управления тиристоров средней мощности 1
Особенности роста эпитаксиальных слоев арсенида галлия в поле гамма-излучения 60
Особливості виготовлення мішеней лазерів на основі халькогенідів свинцю 173
Оценка влияния частоты дискретизации напогрешность измерения мощности дозы блоком детектирования на основе CdZnTe 222
Очистка при кристаллизации из раствора в расплаве 29

П

- Повышение разрешающей способности металлографических исследований многослойных полупроводниковых 109
Повышение селективности травителя для исследования тонких слоев кремния 33
Повышение структурного совершенства эпитаксиальных слоев фосфида галлия 18
Повышение точности компарирования напряжений в области инфразвуковых частот путем оптимального выбора частоты опорной величины 81
Повышение точности передачи размера Вольта напряжения постоянного тока напряжению инфразвуковой частоты 82
Повышение экономической эффективности производства ИК-фотопреобразователей 121

- Полупроводниковые детекторы нового поколения для радиационного контроля и дозиметрии ионизирующих излучений 231
- Получение и исследование свойств прозрачных токопроводящих пленок для элементов опто- и микроэлектроники 105
- Получение кремния электродным восстановлением продуктов пиролиза рисовой лузги 232
- Приближение Пфана и диффузионные процессы в расплавах 87
- Принципи дії, характеристики та параметри елементної бази мікро- та наноелектроніки 245
- Принципы применения CO₂-лазера в интерферометрии 165
- Принципы радиационного управления свойствами полупроводников 94
- Природа несовершенств структуры эпитаксиальных слоев арсенида галлия 24
- Про механізм електролюмінісценції тонкоплівкових структур для пристроїв відображення інформації 207
- Провести литературный обзор по методам получения слоев. Исследовать структурные свойства исходных подложек. Разработать методику эпитаксии слоев 284
- Программа и методические указания курса "Физические основы электронной техники" для студентов заочного отделения специальности 0612 – Промышленная электроника 35
- Программа, методические указания и контрольные работы курса "Микроэлектроника" для студентов заочного отделения специальности 0612 – Промышленная электроника 34
- Программа, методические указания и контрольные работы по курсу "Микроэлектроника и микросхемотехника" для студентов специальности 0612 76
- Процессы растворения и роста кристаллов полупроводников при воздействии излучений 68
- Пути повышения структурного совершенства слоев фосфида галлия при эпитаксии из жидкой фазы 41
- Пути повышения экономичности производства кремниевых солнечных преобразователей 122

Р

- Радиационная модификация свойств кремниевых транзисторов 184
- Радиационная модификация свойств кремниевых транзисторов 185
- Радиационная модификация спектров фотолюминесценции арсенида галлия 208
- Радиационная модификация физических свойств широкозонных полупроводников и создание на их основе лазеров большой мощности 223
- Радиационная обработка ИК-фотоприемников на основе CdHgTe 123
- Радиационная стойкость кремниевых датчиков ИК-излучения 186
- Радиационная стойкость материалов 42, 43

- Радиационная технология управления параметрами элементов и микросхем частного применения 110
- Радиационное изменение структуры кристаллов полупроводниковых соединений 209
- Радиационное легирование арсенида галлия 187
- Радиационное легирование сульфида кадмия и арсенида галлия 144
- Радиационное управление свойствами материалов и изделий опто- и микроэлектроники 133
- Радиационное управление свойствами полупроводников 132
- Радіаційна модифікація параметрів та вивчення стійкості напівпровідникових виробів електронної техніки для космічної апаратури 131
- Радіаційна стійкість виробів електронної техніки 124
- Радіаційна стійкість гібридних інтегральних микросхем 156
- Радіаційне легування сульфідом кадмію 183
- Радіаційно-термічне корегування властивостей арсеніду галію 143
- Разработка методики контроля неоднородности высокоомных фоточувствительных полупроводниковых материалов методом темного зонда для целей микроэлектроники 260
- Разработка процессов получения и исследования свойств элементарных полупроводников и многокомпонентных соединений для повышения стойкости создаваемых на их основе приборов 282
- Разработка способов повышенной надежности получения многокомпонентных соединений для изготовления фотоприемников ИК-излучения среднего диапазона. Делитель. Этап Тп "Исследовать процесс деградации материала активного элемента фотоприемника" 285
- Разработка технологии автоэпитаксии германия из раствора в расплавах металлов 261
- Разработка технологических процессов получения волноводных элементов среднего ИК диапазона и изготовление опытных образцов волноводов и фотодетекторов на их основе 283
- Расчет коэффициента поглощения ИК-излучения свободными носителями заряда в полупроводниках 95
- Расчет объемов выборок для определения причин отказов электрорадиоизделий в составе РЭА 99
- Расчет положения областей термодинамической неустойчивости для твердой фазы систем тела $AxBySi-x-yD$ ($AxBySi-x-yD$) 69
- Расчет фазовых равновесий в многокомпонентных системах 78
- Рост слоев полупроводников в условиях свободной конвекции 70

С

- Свойства легированных углеродных (алмазоподобных) пленок 149
- Свойства легированных углеродных (алмазоподобных) пленок 166
- Свойства монокристаллов $CdZnTe$ для датчиков гамма-излучения 125

- Свойства силовых управляемых вентилях при обратном смещении цепи управления 5
- Свойства тиристоров типа Д-235, 238 в режиме импульсного управления 6
- Свойства эпитаксиальных слоев германия при облучении быстрыми электронами 126
- Селективное наращивание германия из раствора в расплаве 23
- Система для выявления скрытых органических взрывчатых веществ ядерно-физическими методами 252
- Система оптического контроля деформаций торцовой поверхности резьбовых деталей при затяжке 174
- Системы индивидуального дозиметрического контроля 240
- Современные радиационные технологии в управлении параметрами ИЭТ 134
- Современные технологии обеспечения надежности радиоэлектронной аппарата-туры на этапах проектирования и производства 97
- Способ обработки эпитаксиальных слоев кремния 291
- Сравнительный анализ влияния быстрых электронов и нейтронов на эпитаксиальные слои арсенида галлия 196
- Сравнительный анализ известных алгоритмов компьютерной томографии ядерного топлива тепловыделяющих сборок реактораонний ресурс 241
- Стойкий до завад стегано-графічний алгоритм, який використовує просторову область контейнера при стегоперетворенні 216
- Структурні властивості епітаксійних шарів арсеніду галія 7
- Структурные дефекты в многослойных системах высоковольтных транзисторов на эпитаксиальных структурах 44
- Структурные свойства эпитаксальных слоев фосфида галлия 36

Т

- Теоретическое исследование процесса эпитаксии 19
- Теория и практика жидкофазной эпитаксии и радиационной технологии полупроводников 233
- «Терек-1» 286
- «Терек-1». Подготовить партию слоев в условиях заказчика. Рассчитать диаграммы состояния систем на основе соединений типа А2В6. Техническая информация 287
- Термодинамический анализ процессов роста эпитаксиальных слоев многокомпонентных твердых растворов в условиях при-нудительного охлаждения насыщенного раствора-расплава 78
- Термополевой метод контроля качества кристаллов кадмий-цинк-теллур 224
- Технико-экономические задачи эффективного контроля безопасности АЭС 217
- Технология получения легированных алмазоподобных пленок 106

Технология получения легированных алмазоподобных пленок 111
Тонкоплівкові електро-люмінісцентні датчики температури у НВЧ полях
175
Трехмерные дефекты эпитаксиальных слоев фосфида галлия 37

У

Увеличение растворимости кристаллов полупроводников под воздействием ионизирующего излучения 135

Узагальнений комплексний показник якості кремнієвих фотоелектронних перетворювачів для апаратури спеціального призначення 197

Уменьшение плотности дислокаций в эпитаксиальных слоях фосфида галлия 25

Управление качеством структуры эпитаксиальных слоев соединений типа АЗВ5 64

Управление свойствами халькогенидных стеклообразных полупроводников для сенсоров памяти 150

Усовершенствование стегаграфического алгоритма, основанного на SIGN-нечувствительности сингулярных векторов блоков матрицы изображения 246

Устройство для измерения действующего значения напряжения в диапазоне инфразвуковых частот 292

Учебные задания по курсу "Физические основы электронной техники» для студентов заочного отделения специальности 0612 38

Ф

Физико-технические основы радиационной технологии полупроводников 136

Физические принципы радиационной модификации приборов твердотельной электроники 198

Фізико-технічні основи мікроелектроніки 137

Фізико-технічні основи мікроелектроніки 253, 254

Фізичні основи мікро- та наноелектроніки 167

Формирование омических контактов на поверхности полупроводниковых соединений 91

Щ

Щодо удосконалення напівпровідникових лазерів з електронним накачуванням 168

Э

- Электротехнические элементы на основе алмазоподобных пленок 138
- Эпитаксия германия из раствора-расплава для получения многослойных систем 14
- Эпитаксия слоев в поле гамма-облучения 50
- Эпитаксия слоев в радиационном поле 45
- Эпитаксия слоев в радиационном поле 61
- Эпитаксия слоев германия из жидкой фазы в поле гамма-облучения 51
- Эпитаксия слоев полупроводников в поле гамма-излучения 139
- Эпитаксия слоев полупроводников в поле гамма-излучения 151
- Эпитаксия слоев полупроводниковых материалов в поле гамма-облучения 39
- Эпитаксия слоев фосфида галлия для светодиодов 15

М

- Multiple Energies Passive Computer Tomography of Nuclear Fuel 255

Т

- The block of detecting scale-radiation on the basis of CdZnTe-gauge for systems of the radiating technological control 247
- The detector on basis of CdZnTe-gauge for systems radiating-technological control 248

АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ

А

Андріянов А. В. 104, 137, 158, 167, 175, 195, 207, 245, 254
Анисимов В. А. 174, 190

Б

Банзак О. В. 176, 177, 178, 179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189,
191, 196, 198, 199, 200, 201, 202, 208, 209, 211, 214, 218, 219, 220, 222, 224,
225, 226, 228, 230, 231, 234, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 249, 250, 252
Батиене Л. Е. 246
Белецкий П. Н. 57
Бобок И. И. 246
Бойко В. А. 105
Бойко Д. В. 113, 118
Борисенко І. І. 216
Букаев В. 9, 12
Бурков А. А. 212

В

Васькова Н. А. 78, 80, 86
Видолоб В. В. 157, 159, 164, 168, 169, 171
Волосевич В. П. 179, 180, 187, 198

Г

Гаркавенко А. С. 90, 91, 95, 119, 130, 133, 144, 159, 163, 164, 165, 205, 210,
214, 223, 237, 238, 257
Гахович С. В. 154
Головченко К. О. 251
Гордієнко Ю. О. 192, 203
Грасовский С. В. 150, 160, 166
Гребенников А. А. 268
Гроза В. П. 102
Грудинкин В. М. 129
Гунченко Ю. О. 188, 191, 199, 200, 201, 202, 206, 208, 209, 211, 214

Д

Давлетов Е. Н. 193, 204
Данильченко Б. 39, 45, 49, 51, 61

Даховский И. В. 58, 70
Дмитрієв М. В. 116
Дорош А. Г. 81
Дранчук С. Н. 33, 36, 37, 41, 42, 44, 46, 47, 58, 59, 64, 70, 71, 73, 74, 75, 78,
79, 80, 83, 86, 87, 88, 92, 94, 96, 108, 109, 137, 147, 213, 221, 229, 233, 243, 254,
275, 280, 284, 286, 287
Дружинін А. О. 192, 203

Ж

Желудков В. М. 26, 27
Жеревчук В. В. 101, 104
Жуков С. А. 151

З

Завадский В. А. 15, 18, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 53, 63, 109, 110, 114, 115, 122,
123, 124, 127, 128, 132, 133, 134, 140, 146, 149, 196, 213, 221, 225, 229, 233,
236, 237, 238, 243, 264, 269, 271, 272, 273, 274, 275, 277, 278, 279, 281, 285
Завьялов С. В. 106, 111
Запорожченко Ю. А. 283
Захрабов Ю. А. 154
Зорило В. В. 212
Зубарев В. В. 97, 99, 103, 116, 123, 124, 130, 131, 133, 137, 141, 142, 144,
147, 149, 155

К

Казаков А. И. 13, 14, 19, 23, 24, 29, 53, 65, 77, 102, 158, 175, 182, 193, 204,
207, 261, 263
Календин В. В. 90
Каримов Н. 74
Кишмар И. Н. 65
Кобозева А. А. 246
Коваленко В. Ф. 28
Кособуцкий П. С. 91
Крижановский А. Н. 79
Куброва Т. Н. 57
Кузнецов В. И. 3, 4, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 22, 25
Кулаков В. М. 42, 43
Курицин Е. М. 39, 40, 43, 45, 49, 50, 51, 54, 60, 61, 94, 126, 138, 148, 176, 185,
186, 233, 276, 282, 291
Куценко А. Н. 174, 190

Л

- Лагутин В. В. 162
Легеева С. Д. 44
Ленков С. В. 97, 99, 113, 118, 120, 125, 127, 128, 130, 133, 134, 136, 137, 138, 140, 141, 143, 144, 146, 147, 148, 151, 153, 154, 155, 156, 157, 159, 160, 161, 163, 164, 165, 169, 171, 188, 191, 192, 194, 196, 197, 200, 201, 202, 203, 205, 206, 208, 209, 210, 211
Лепіх Я. І. 153, 170, 176, 192, 194, 196, 197, 203, 208
Лещенко О. И. 250
Ликов О. І. 155, 156
Литвин А. А. 33, 36, 37, 41, 46, 47, 58, 59, 70, 71, 75, 79
Лукомский Д. В. 116, 117, 127, 128, 130, 134, 140, 143, 153, 157, 197

М

- Максимов М. В. 145, 152
Марончук И. Е. 28, 232
Масенко Б. П. 114, 122, 232
Маслов О. В. 120, 125, 145, 152, 215, 217, 218, 219, 220, 222, 224, 225, 227, 228, 230, 231, 234, 239, 240, 241, 242, 244, 249, 250, 252, 253
Матковский А. О. 93
Медведенко Ю. С. 162
Миронов В. С. 107, 158
Михлин О. М. 257
Монаков С. В. 153

Н

- Никитин В. Э. 139
Николаенко Ю. Е. 152
Николаенко Ю. М. 145

О

- Огарь Д. К. 117, 121
Огарь И. В. 113, 116, 117, 118, 121
Онищенко Ю. Ю. 102
Орел В. И. 10, 28
Охрамович М. М. 183, 187, 189, 197

П

- Павлов В. В. 23
Пашков О. С. 163, 168, 169, 170, 171, 188, 191

Пащенко Э. М. 24
Перегудов А. Н. 103, 136, 141, 142
Песоцкий Г. 9, 12
Петров Д. К. 182
Повстяной М. В. 232
Полонский Б. 258
Поляруш О. В. 101, 103, 105
Прохоров В. А. 172, 173

Р

Ранченко Г. С. 129
Рвачев А. Л. 1, 2, 5, 6
Романенко В. Н. 77
Ротнер С. М. 106, 111, 112, 139, 150, 160, 162, 166
Рыбин В. Н. 260, 266, 267, 270
Ряба Л. О. 183

С

Савельев А. А. 92, 96, 98, 99, 100, 105, 120, 124, 125, 126, 131
Савков П. А. 154
Салимов Р. М. 131
Самков Е. Я. 16
Селюков А. В. 177, 181, 207, 226
Симаков В. В. 44
Смолкин В. Б. 23
Стриженюк С. С. 102
Сугак Д. Ю. 93
Сухарев Ю. Г. 262, 265, 268

Т

Тариелашвили Г. Т. 136
Тимошенко Л. М. 235
Титов А. В. 1, 2, 5, 6
Тищенко В. В. 174
Ткач М. П. 16, 20, 21
Тузовский А. М. 79

У

Убизский С. Б. 93
Умурзаков К. 74

Ф

Фишер З. А. 99

Х

Хитова Л. 77

Хоппе П. 57

Ц

Цацко В. И. 57

Ш

Шереметиков А. С. 174

Шеховцов В. И. 39, 40, 45, 49, 50, 51, 61

Шобик В. С. 30, 32, 41, 42, 46, 47, 48, 64, 67, 72, 73, 76, 79, 84, 147, 233

Я

Якименко I. З. 235

В

Banzak O. V. 247, 248

М

Maslov O. V. 247, 248, 255

S

Sokolov A. V. 255

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ

<https://opu.ua/ru/iibr/history>

<http://ics.opu.ua/rus/institute/historyics>

http://irt.opu.ua/rus/science/academic_council

<https://scholar.google.com.ua/citations?user=3ayR8SIAAAAJ&hl=ru>

<https://opu.ua/science/research/2136>

<https://opu.ua/ru/library/bibliography/scientistsonpu>

<https://drive.google.com/file/d/1H-JEfW-ViHsM0j8mIHnWx30eRRy9ea9z/view>

http://eprints.library.odku.edu.ua/2044/1/19_mnpk_Odesa_2018_43.pdf

[http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92\\$](http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%96%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%92$)

<http://www.tkea.com.ua/siet/ukr.html>

<https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1012795>

<http://vo.od.ua/rubrics/o-detyakh-dlya-detejj/40905.php>

<http://prichernomorie.com.ua/odessa/monitorings/2018-07-31/198434.php>

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА	5
ОСНОВНІ ДАТИ ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ В.А. МОКРІЦЬКОГО.....	6
КОРОТКИЙ БІОГРАФІЧНИЙ НАРИС	8
О КОЛЛЕГАХ, ДРУЗЬЯХ И О СЕБЕ (воспоминания).....	13
ЛІТЕРАТУРА ПРО ЖИТТЯ ТА ДІЯЛЬНІСТЬ	32
ХРОНОЛОГІЧНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ	33
ПОКАЖЧИК ЗВІТІВ НДР	63
АВТОРСЬКІ СВДОЦТВА ТА ПАТЕНТИ	68
ДИСЕРТАЦІЇ ПІД НАУКОВИМ КЕРІВНИЦТВОМ В.А. МОКРІЦЬКОГО..	68
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК ДРУКОВАНИХ ПРАЦЬ	70
АЛФАВІТНИЙ ПОКАЖЧИК СПІВАВТОРІВ	84
КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ	89
ЗМІСТ	90